原子衝突研究協会誌 2011年第8巻第6号

Journal of Atomic Collision Research



原子衝突研究協会賛助会員(五十音順)

アイオーピー・パブリッシング・リミテッド(IOP英国物理学会出版局)

http://journals.iop.org/

Institute of Physics

アステック株式会社



有限会社 イーオーアール

http://www.eor.jp/



株式会社 オプティマ

110p.// 1111.001.jp/

http://www.optimacorp.co.jp/

http://www.canberra.com/jp/

http://www.astechcorp.co.jp/

Optima Corp.

キャンベラジャパン株式会社



クリムゾン インタラクティブ プライベート リミテッド



http://www.enago.jp/ http://ulatus.jp/ http://www.voxtab.jp/

株式会社 サイエンス ラボラトリーズ

http://www.scilab.co.jp/



真空光学株式会社

http://www.shinku-kogaku.co.jp/

http://www.spectra-physics.jp/

真空光学株式会社-Vacuum & Optical Instruments-

スペクトラ・フィジックス株式会社





ツジ電子株式会社



http://www.tsujicon.jp/

http://www.tokyoinst.co.jp/

株式会社東京インスツルメンツ



株式会社東和計測



株式会社トヤマ



株式会社 ナバテック

A Statec

仁木工芸株式会社

伯東株式会社

http://www.touwakeisoku.ecnet.jp/

http://www.toyama-jp.com/

http://www.navatec.co.jp/

http://www.nikiglass.co.jp/



http://www.g5-hakuto.jp/



二木 工 芸 株式会社

株式会社パスカル



http://www.pascal-co-ltd.co.jp/

http://www.ec-marubishi.co.jp/

丸菱実業株式会社



MARUBISHI CORPORATION

株式会社メディア研究所



http://mediken.jp/

株式会社 ラボラトリ・イクイップメント・コーポレーション

http://www.labo-eq.co.jp/



しょうとつ

第8卷第6号

目 次

(巻頭言)「協会から学会へ」の名称変更について	(松澤通生)		5
(シリーズ) 短波長自由電子レーザーによる原子分子光物理 シリーズ開始にあたり	(足立純一)		7
(シリーズ) 短波長自由電子レーザーによる原子分子光物理 第一回 極紫外自由電子レーザーの原理と利用研究	(永園 充 et al.)		10
(総説)気液界面反応機構と大気化学	(藪下彰啓)		18
(シリーズ) 衝突論ノート VIII. 低エネルギー衝突でも摂動論 -たかがボルン近似,されどボルン近似-	(島村 勲)	•••	27
(原子衝突のキーワード)「原子衝突のキーワード」によせて -発案者による趣旨説明のようなもの-	(田沼肇)		34
(原子衝突のキーワード) 実効温度	(田沼 肇)	•••	35
(原子衝突のキーワード) エフィモフ状態	(数納広哉)	•••	36
(原子衝突のキーワード)ドレスト原子	(佐甲徳栄)	•••	37
理研シンポジウム「第2回拡がる原子分子物理研究: 先端光技術で切り開く新しい原子分子物理」のお知らせ		•••	38
原子衝突若手の会 第 32 回秋の学校開催報告	(石黒雄介)		39
鹿又一郎先生のこと	(金子洋三郎)		40
第 13 回原子衝突研究協会若手奨励賞募集要項	(庶務幹事)		43
原子衝突研究協会役員選挙公示	(選挙管理委員会)		43
会長・運営委員選挙への電子投票導入のお知らせとお願い -重ねて・雑文-	(庶務幹事)		44
国際会議発表奨励事業に関するお知らせ	(庶務幹事)		45
「しょうとつ」原稿募集	(編集委員会)		46
今月のユーザー名とパスワード		•••	46

短波長自由電子レーザーによる原子分子光物理 シリーズ開始にあたり

足立純一 高エネルギー加速器研究機構 物質構造科学研究所 放射光研究施設 adachij@post.kek.jp

平成23年10月27日原稿受付

原子分子光物理 (AMO) の分野では,メーザ ー・レーザーの出現により,様々な研究展開の道 が拓かれた[1]. 例えば, 強い単色レーザー光は, 分光学的な分解能を著しく高めただけでなく、従 来の光源では本質的に観測不可能である多光子 遷移のような高次輻射過程の観測を可能にして いる. そのような強いレーザー光が. さらに強く (高いパワー密度),さらに短波長になるとき,原 子・分子・クラスターとそのレーザー光との相互作 用により、どのような現象が引き起こされるのか、こ の分野の研究者の興味を惹きつけている[2].し かし,紫外光よりも短波長になると、レーザー発振 のための適切な光学媒体がほとんどなく、共振器 を構成する光学素子も適当なものがほとんどない. そのため、従来型のレーザー技術では短波長化 は不可能である.

現在,強い短波長レーザー光を生成されるた めには,2 つの方法がある.その1 つが,高強 度レーザーを利用した高次高調波発生による方 法である.もう1 つは,加速器技術の最先端の 粋を結集した自由電子レーザー (FEL) による方 法であり,本解説シリーズで紹介する研究で用い られる手法である.

国家基幹技術の一つとして指定された X 線 自由電子レーザー (XFEL) は,理化学研究所 播磨研の大型放射光施設 (SPring-8) において 開発・整備が進められている. 2011 年 6 月 7 日に 波長 1.2 Å の X 線レーザーの発振に成功し, スタッフのさらなる努力で短波長記録を塗り替え て,7月13 日には 0.8 Å のレーザー光が得られ ている[3]. その愛称は SACLA (SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser) と決定さ れ,世界中の研究者に開かれた施設として, 2011 年度内には供用運転を開始する予定である. 新 たに手にした XFEL の利用により,物質科学に おける新しい研究展開が期待されている.

この SACLA の建設に先立ち, XFEL の実現 に向けた新しい要素技術の実証のため, SPring-8 サイトに試験加速器 SCSS (SPring-8 Compact SASE[4] Source)[5] が建設されている.この SCSS では極端紫外光領域 FEL (EUV-FEL) の 発振に成功しており, 国内外の研究者からの公募 課題による共同利用が行われている.赤外・可視 レーザーおよび放射光の利用の黎明期にて, AMO 分野がその光自体の特徴の測定や物質の 相互作用の基礎過程の解明において重要な役 割を果たしたように, 初めて手にした EUV 領域 の FEL の利用研究においても, AMO の分野 で開拓的な成果が得られている.

そこで、『しょうとつ』誌において、短波長 FEL を用いた研究での成果 (計画)を紹介していた だく記事を、AMO に近い分野で研究されている 方に執筆していただくことを企画した.すでに、多 くの注目すべき成果が挙げられているため、「短 波長自由電子レーザーによる原子分子光物理」と 題してシリーズ化し、複数の研究グループの方々 に解説記事を執筆していただくことにした.同様 な解説は、すでに『放射光』第 23 巻 5 号 (2010) に特集されている.けれども、原子衝突研 究協会の協会員の皆さんと放射光学会の会員と の重なりはさほど大きくないと判断し、また、その 後も進展があるため、『しょうとつ』誌でもシリーズと して解説記事を執筆していただくことは意義があ るだろう.

シリーズ第 1 回は, SCSS 試験加速器施設の 利用連携チームのチームリーダーである永園氏 に執筆を依頼した. FEL の発生原理について, そして, SCSS を利用した実験に興味のある方に は, 是非, 今号のシリーズ第 1 回の永園氏の記 事 [6] を読んでいただきたい.

短波長の領域において,物質科学研究に利用 でき,波長可変性を有する実用光源は,シンクロト ロン放射 (SR) による光がある. SR 光と比較する と,FEL の特徴として高輝度性・短パルス性・高 い空間コヒーレント性が挙げられる. これらの特徴 は,可視近赤外領域の先端のレーザー光の持つ 特徴である. そのようなレーザーと短波長 FEL と を比べたとき,1 つの欠点として,時間コヒーレン ト性が欠如していることがある. これは,現状での FEL の発振には SASE 方式[4] を用いている ためである. このことは,より精密な実験を進めて いく上で障害となっている.

短波長 FEL 施設の世界的な現状を手短に記述しておこう.短波長 FEL は現在,日本のSCSS [基本波 61-51 nm]の他に,ドイツのFLASH (Free-Electron Laser in Hamburg) [47-6.8 nm] [7],米国のLCLS (Linac Coherent Light Source) [2.6-0.62 nm] [8] が稼働中である.基本 波の波長域は,EUV から軟 X 線にわたる領域であり,互いに異なっている.SACLAの発振成功により,SCSS は"試験"加速器としての基本的な役割は終えている.しかし,EUV 領域における FEL は世界的に見て,現時点では唯一のものであり,今後も,EUV 領域のレーザー光源として,EUV 光と物質との相互作用素過程の研究,そして,その相互作用を用いた物質科学において,重要な役割を担っている.

それぞれの施設において、より短波長である Angstrom 領域の XFEL 発振が目指されている. 日本では前述の SACLA が完成して調整中であ り、米国では LCLS の加速器が延長され 2.5-1.2 Å を得るための調整が行われている. 欧 州では X 線領域での FEL を目指した, EuroFEL (European FEL) [9] が建設開始されて いる. また, 韓国の Pohang (浦項) では 10 GeV の線形加速器を備えた PAL (Pohang Accelerator Laboratory) XFEL の建設が, この 4 月から始ま っている [10]. そして, スイスの Paul Scherrer Institute においても, 試験加速器の建設が始ま っており, XFEL 施設 SwissFEL の 2016 年完 成を目指して計画 [11] が進められている.

上述したように、現状の短波長 FEL の多くは SASE 方式であり、時間的コヒーレンス性の高い 光ではない. これを克服するためには、FEL の発 振波長に同調したレーザーを用い、FEL に種 (seed) を与える必要がある. すでに、それぞれの 短波長 FEL 施設でシード型 FEL の実現に向 けた研究開発が進められている. SCSS において も、EUV 領域でレーザーの高次高調波発生によ る光をシードとした FEL の発振に成功している [12]. イタリアの Elettra においては完全コヒーレ ンスを目指したシード型 FEL である FERMI (100-10 nm) [13] がすでに建設され、調整運転 が始まっている.

短波長 FEL に関連した計画をもう 1 つ紹介 しておく.異なる次世代放射光として,エネルギー 回収型線形加速器 (ERL) が提案されている [14]. 日本では高エネルギー加速器機構にて計 画が進められており、その概念実証機であるコン パクト ERL (cERL) の建設が始まっている. 実機 の ERL は,展開される研究の詳細な検討,より 現実的な建設経費の考慮が進められ,3 GeV ERL の設計が行われている.現在の計画では, 2015 年に建設を開始し, 2020 年に共同利用へ の公開を目指す計画となっている. その先の第2 期計画として, 共振器型 XFEL (XFEL-O) が提 案されている.これは、完全結晶による X 線の Bragg 反射を利用して共振器を構成する方式 [15] の FEL である. この XFEL-O が実現する と,まさに桁違いの X 線が得られ,量子光学研 究だけでなく,さらに新しい物質研究の世界が拓 かれるだろう.

強いレーザー場中にある原子・分子系につい て、定常的電子状態の理論研究はすでに多くが 行われている[1].現実的には、パワー密度のピー クに至るまでの過渡的な現象や、電離・解離によ る対象としている系の構成粒子の変化とその時間 発展も、現象の理解に不可欠であり、実験的研究 の対象としても非常に興味深い.今後、本解説シ リーズが、協会員の皆さんの EUV-FEL あるいは XFEL を用いた研究の理解に役立ち、興味をも たれた方の新規に参入していただける足がかりに なれば幸いである.

参考文献および註・コメント

 "Physics of Atoms and Molecules (2nd Ed.)
 Sec. 15", B.H. Bransden and C.J. Joachain (2003, Pearson Education).

- [2] K. Yamanouchi, Science 295, 1659 (2002).
- [3] http://xfel.riken.jp/
- [4] Self Amprified Spontaneous Emission の略.
- 本号の永園氏の記事を参照のこと.
- [5] http://xfeluser.riken.jp/scss/top_scss.html

[6] 担当編集委員の個人的な印象では, "超蛍 光"現象は非常に興味深いものであり, 理研の広 報サイト

http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/201

1/111021_2/detail.html

に紹介されているように、"革新的" な研究が期待 できる. 最初の報告が Phys. Rev. Lett. 107, 193603 (2011) として発表されたばかりであり、機 会を改めて詳細を解説していただきたいと思って いる.

- [7] http://flash.desy.de/
- [8] http://lcls.slac.stanford.edu/

[9] http://www.xfel.eu/

[10] インターネット上での情報を見つけられず, 建設開始については聞き伝えである.

http://fel2010.maxlab.lu.se/FEL2010_proceedings/ papers/mopc19.pdf

[11] http://www.psi.ch/swissfel/

[12] Opt. Express 19, 317 (2011);

http://www.s.u-tokyo.ac.jp/ja/press/2011/01.html

[13] http://www.elettra.trieste.it/FERMI/

[14] http://pfwww.kek.jp/ERLoffice/

[15] K-J. Kim *et al.*, *Phys. Rev. Lett.* **100**, 244802(2008).

シリーズ

短波長自由電子レーザーによる原子分子光物理 第一回 極紫外自由電子レーザーの原理と利用研究

永園充^{*},田中隆次,矢橋牧名,田中均,石川哲也
 理化学研究所 播磨研究所
 * nagasono@spring8.or.jp
 平成 23 年 9 月 27 日原稿受付

SCSS 試験加速器が発生する極紫外(EUV)領域の自己増幅自発放射型の自由電子レーザー (SASE-FEL)の利用に関する情報提供を目的として, SASE-FEL の原理と光特性, および共用基盤設備 について解説する. 共用基盤設備は使用頻度の高いガスアッテネータ, ガスモニター, 集光システム, 同 期レーザーシステムについて述べる. また, SCSS 利用研究の1例として, EUV-FEL 照射によって, 量子 光学効果の1つである超蛍光現象が観測されたことについて紹介する. この研究成果は, X 線自由電子 レーザー照射によるX 線超蛍光の発生を示唆するものである.

1. はじめに

真空紫外よりも短波長領域の高強度な実用光 源として、シンクロトロン放射光(以下、放射光)が 広く用いられている. 放射光の利用実験は, 当初, 高エネルギー実験用加速器に寄生する形で始ま り(第一世代放射光),その有用性が認知される のに伴い, 放射光利用実験専用の蓄積リング型 加速器が建設されるに至った(第二世代).その 後,さらに一層の高輝度化を目指して,挿入光源 (アンジュレーター:周期磁場発生装置)利用に最 適化された第三世代放射光源が建設され,広く 普及している. 第一世代では, 各種分光実験技 術の開発とそれを用いた物理・化学の基礎研究 が主流であったが、世代が進む(高輝度化)ととも に利用分野も広がり,生物科学や材料科学などを 中心に様々な分野で利用され,数多くの成果が 上がっていることは周知の通りである.しかしなが ら, 第三世代放射光源も, 輝度は高いものの所詮 カオス光源である. レーザーのようにコヒーレンス 度が高い光や, 第三世代放射光源よりも更に高 輝度で、なおかつ短パルス性も有する、いわゆる 第四世代光源の開発を目指す動きは、1990年代 から2000年代にかけて大きく進展した.

自由電子レーザー(Free Electron Laser: FEL)は,波長の制約がないコヒーレント光源とし

て1970年代に提案された[1]. その発生原理は, アンジュレータ内における光と電子ビームの相互 作用により,電子を光の波長間隔に整列させ,整 列した電子がコヒーレントに運動することによって, コヒーレントな電磁波を放射するというものである. 当初は,アンジュレータの両側に高反射率ミラー を設置して共振器を構成する,光共振器型の自 由電子レーザーが実用化され,赤外から紫外領 域で応用された.しかしながら,より短波長の領域 には高反射率ミラーがないという技術的問題があ った.その問題解決方法として,共振器に代えて 長いアンジュレータを利用する自己増幅自発放 射 (Self-Amplified Spontaneous Emissio: SASE)型自由電子レーザー(2 章参照)が 1980 年代に提案された[2,3].

SASE-FELの提案により短波長領域への制約 がなくなったことで、第四世代光源の一つの可能 性として、X線自由電子レーザー(XFEL)の検討 が1990年代から進められ、2000年代より日米欧 において建設が開始された.米国では、スタンフ オード国立加速器研究所にてLCLS(Linac Coherent Light Source)と呼ばれるXFEL施設 が建設され、2009年春に世界で最初の硬X線 (波長1.5Å)のFEL発振に成功した.2009年秋 からはユーザー利用が開始された.ヨーロッパで は、ドイツのハンブルクにて European XFEL 施 設が2015年の利用開始を目指して建設が進めら れている.日本では、2006年からの5ヵ年計画で 理化学研究所と高輝度光科学研究センターによ り組織された XFEL 計画合同推進本部にて XFEL 施設が建設され、2011年6月にX線(波 長 1.2Å)の増幅に成功した.現在、2011年度内 の供用開始に向けて調整運転が行われている.

この XFEL 施設は, SACLA (SPring-8 Angstrom Compact Free Electron Laser)と名 付けられた. ごく最近, 韓国, スイスにおいても, XFEL 施設の建設計画がスタートしており, 他の 国でも続々と計画が検討されているようである.

日本とドイツでは、XFEL 施設の建設に先立つ プロトタイプとして,極紫外(Extreme Ultraviolet: EUV)領域の自由電子レーザー施 設が建設され,現在もユーザー利用実験が展開 されている.

ドイツでは、ドイツ電子シンクロトロン研究施設, DESY で当時進められていた TESLA (TeV Energy Superconducting Linear Accelerator)計画の中で超電導加速空洞の試 験施設 TTF(Tesla Test Facility)が建設され、 SASE-FEL の基礎研究が行われた. TTF 施設 では、2000年に波長 109 nm の SASE-FEL が 発振し[4], 最初の SASE-FEL 利用実験も行わ れた[5]. その後, DESY が高エネルギー物理か ら光科学へと研究の重心を移す中で, TTF の技 術をベースに EUV から軟 X 線領域の SASE -FEL 利用実験施設, FLASH (Free-Electron Laser in Hamburg)を建設し、2005年8月から ユーザー利用が始まった.現在(2011年10月), 1.25GeVの電子ビームで波長 4.12 nm までの利 用が可能である.

日本では、2001 年にコンパクトな XFEL 光源 を目指した開発研究 SCSS(SPring-8 Compact SASE Source)プロジェクトが策定され、その原理 実証のため、2005 年に SCSS 試験加速器が建 設された. 2006 年には波長 49 nm のレーザー増 幅を観測し、2007 年に波長 51~61nm の真空紫 外領域の SASE-FEL の発振と出力飽和を達成し た[6]. 並行して,加速器運転の安定化を目指した加速器コンポーネントの改良が行われた[7]. さらに次世代 FEL であるシード FEL の研究も進められている [8]. 一方, SCSS 試験加速器の利用研究は, XFEL の利用機器の基盤開発としての役割と,各方面から寄せられた EUV 領域における新たなサイエンス開拓への期待を受け,2007年度より利用研究のためのビームライン整備が進められ,2008年度からユーザー利用が開始された.

本稿は、SCSS 試験加速器からの EUV-FEL 利用に関する情報提供を目的とする.先ず, SASE-FEL の発生原理,及び EUV-FEL の光 特性について,第2章及び第3章に述べる.第4 章では利用基盤設備について紹介し,第5章で は利用の概要を記す.最後に利用研究の一例と して、"EUV-FEL 励起による超蛍光の観測"[9] について第6章に紹介する.なお、XFEL 施設 SACLA に関しては、紙面の都合上紹介しない. 興味がある方は、理研のホームページ等を参照し ていただきたい[10].

2. SASE 型 FEL の原理

一般的に FEL は、光を閉じこめる光共振器と光 を増幅する媒質という,従来型レーザーと同様の 構成をとる. ただし, 高エネルギーかつ高密度の 電子ビームと、アンジュレータと呼ばれる周期磁 場発生装置が増幅媒質の役割を果たす.原理的 には波長を自由に選択でき,かつ光を吸収する 媒質が必要でないことから, 短波長レーザーの実 現を目指した R&D が進められてきた.しかし, 100 nm 以下の波長領域で十分な反射率を有す る実用的なミラーがなく、これが「従来型」FEL の 実質的な短波長限界を決めてきた. SASE 型 FEL はこの限界を打ち破るために提案された方 式であって、光共振器で光を閉じ込めて媒質との 相互作用の距離を稼ぐのではなく, 媒質自体(即 ちアンジュレータ)を長くすることによって高いレー ザー利得を得るという概念に基づいている.

FEL の原理を理解するにはコヒーレント光の概 念が重要であるので、図1を用いて簡単に説明す



る.青丸が電子ビームを形成する個々の電子,赤 線が各電子から放出される光,即ち電磁波を示 す. (a)のように電子ビームの長さ lb が放出される 光の波長λよりも長い場合, 個々の光の位相には 相関がなく,電子ビームから放出される光の強度 は単一電子からのそれの電子数(N)倍である. 一 方, (b)のように lb が んよりも短い場合は殆どの光 の位相が一致し,電磁波の振幅としてN倍,光の 強度としては N² 倍となる. 一般的に(a)を自発放 射, (b)をコヒーレント放射と呼ぶ. コヒーレント放 射が起こるためには、lb がんよりも短いことが必要 であるが,一つだけ例外がある.即ち,(c)のよう に、電子の塊が光の波長と同じピッチで規則正し く並んでいる場合,言い換えると電子密度がλの 周期で変調されている場合である.これをマイクロ バンチと呼ぶ.マイクロバンチが形成された電子 ビームからは、(b)と同様に波長 λ において光の 位相が整合し、やはりコヒーレント放射が起こる. FEL とはこのように、マイクロバンチが形成された 電子ビームから放出されるコヒーレント放射である と言い換えることができる.

マイクロバンチは次の3つの過程を経て形成される.

- 電子ビームと同期した光(シード光)がアンジ ュレータに入射される.
- ② 光との相互作用により、波長と同じ周期での エネルギー変調が電子ビームに誘起される.

 アンジュレータを進むにつれて、エネルギー 変調が密度変調(マイクロバンチ)へと変換される.

SASE型 FEL におけるシード光は、アンジュレ ータ入口付近において生成された自発放射光で あるが、これは電子ビームに不可避的に存在する ショットノイズ(分布のばらつき)に起因するもので あり、空間的にも時間的にもインコヒーレントな光 である.電子ビームがアンジュレータを進む増幅 過程で空間コヒーレンス(空間的に異なった光の 可干渉性)は劇的に改善し、いわゆるレーザー出 力飽和に至った時点でほぼ 100%となる.即ち、 回折限界光(集光サイズが波長程度まで可能な 光)に近づく.一方、出力飽和状態でも時間コヒー レンス(光進行方向の可干渉性)は 100%まで改 善されることはなく、光パルスの時間構造やスペク トルは多数のスパイク(モード)から構成される.

SASE型 FEL のこの欠点を改善する手法とし て期待されているのがシーディングである.即ち, ショットノイズを起源とする自発光の代わりに,コヒ ーレンスの高い単ーモードレーザをシード光とし て電子ビームに同期して入射する.この場合,増 幅される光の特性は保存されるため,単ーモード の大強度レーザーが得られることになる.ただし, 入射するレーザーパワーがある閾値(自発光のパ ワーに依存)より低い場合は,レーザーではなく自 発放射がシード光として機能するため,SASE型 FEL へ帰着する.

3. SCSS 試験加速器 EUV-FEL の光特性

SCSS 試験加速器は, 電子ビームエネルギー 250 MeV の線形加速器と周期長 15mm の短周 期真空封止アンジュレータを組み合わせて構成さ れた SASE 型 FEL である. 表 1 に SCSS 試験

表 1. SCSS 試験加速器 EJUV-FEL の光特性

Radiation wavelength at	51 ~ 61 nm
saturation condition	
Spectral width (FWHM)	1 %
Pulse energy average	$\sim 30 \ \mu J/pls$
Intensity fluctuation	< 10 %
Pulse duration (FWHM)	~ 100 fs
Polarization	Horizontally linear
Repetition rate	30 Hz



加速器からの SASE-FEL の光特性を示す. 基本 波の波長領域は 51~61nmnm の EUV 領域で ある. 中心波長 60 nm の極紫外自由電子レーザ ー(EUV-FEL)光のスペクトルを図 2 に示す. 青 線はシングルショット,赤線は 50 ショットの平均ス ペクトルである. EUV-FEL 光は,設定波長を中 心に異なったスペクトラムの光を発振し,スペクト ル幅の平均は約1%(FWHM)である. スパイク状 のスペクトル構造は, SASE-FEL が原理的に時 間方向に多モードで発振されているからである.

4. 共用基盤設備

共用基盤設備は、EUV-FEL 光の利用実験を 効率良く遂行するために整備された機器システム であり、ビームライン、同期フェムト秒レーザーシス テム、共用実験装置などである.また、ここで開発 された基盤機器の一部は SACLA の基盤機器と して応用されている.本章ではビームラインと同期 フェムト秒レーザーシステムについて紹介する.

4.1. ビームライン

ビームラインは、SCSS 試験加速器で発生した EUV-FEL光を実験目的に応じて加工しながら実 験ステーションまで輸送するシステムであり、加速 器収納部からEUVレーザー実験棟までつながっ ている.加速器収納部内のビームラインは、輸送 系ビームラインと光診断システムがある.輸送系ビ ームラインは、2枚の平面ミラー(M1,M2)により EUVレーザー実験棟(9m×14m)へFEL光を 導く.光診断システムには、上流側ミラー(M1)の 退避によりFEL 光が導かれ, パルスエネルギーと スペクトルが測定される [11]. EUV レーザー実 験棟内のビームラインは, ビームライン基盤機器と してアッテネーター(ガス・固体), パルスセレクタ ー[12], 4象限スリット, ガスモニター, 分岐チャン バー, 集光システム[13], 光プロファイルモニター などが整備されていている(図3参照). ここでは, 使用頻度の高い3つのビームライン基盤機器(ガ スアッテネータ, ガスモニター, 集光システム)を 紹介する.

ガスアッテネータは,光強度(パルスエネルギ ー)を広範囲に制御するために用いられる. EUV-FEL 光と物質の相互作用による非線形光 学現象の研究において,観測対象となる信号の 光強度依存性測定はもっとも重要な実験であり、 ガスアッテネータが使用されている. ガスアッテネ ータシステムは、ビームラインに差動排気装置2 つを1.2 mの離して設置することで真空障壁なし のガスセルを構築し、そのガルセルに圧力制御可 能なガス導入バルブを介してArガスを導入でき, ガス圧を変えることにより FEL 光の透過率を制御 する. EUV-FEL 光の基本波の透過率が 100 % ~ 1 %程度まで制御可能である. 透過率が1% より小さい領域では,透過 FEL 光の主成分は 3 次高調波となる.これは、基本波の光エネルギー がArのイオン化ポテンシャル付近にあり, 高調波 成分に比べて光吸収断面積が非常に大きいこと に起因している. つまり, ガスアッテネータは, 高 調波成分を通すハイパスフィルターとしても機能 する.

ガスモニターは、ショット毎の光強度(パルスエ ネルギー)を非破壊計測する基盤機器である. EUV-FEL光は、ショット毎に光強度は 10%程度 の変動幅があり、非線形光学現象などの光強度 に敏感な実験ではショット毎のデータが必須であ る.このために、FEL光の 1%程度だけを利用し て光強度を計測し、ほとんどの光をビームライン下 流側へ供給可能なガスモニターが開発された.ガ スモニターシステムは、ガスアッテネータと同様に 2つの差動排気装置を用いた真空障壁なしのガ スセルにArガスを 10⁻² Pa 導入し、FEL光照射





により生成した Ar イオンを電極で捕集し, 検出信 号をプリアンプで増幅, A/D コンバータを経てデ ータ収集系に送り, ショット毎に記録する. 記録さ れた値からパルスエネルギーへの較正は, 産総 研のカロリーメータ, ドイツの PTB/DESY のガス モニターを用いて行われた[13].

集光システムは、FEL 光を集光することにより 非常に高い光電場を生成し、FEL 光による非線 形光学現象や光誘起反応などの観測実験に使 用される. EUV-FEL ビームラインに整備された 集光システムは、FEL を2枚のミラーによりそれぞ れ水平及び垂直方向に集光する[x1]. ミラー中心 から焦点(試料位置)までの距離を 1m と長くし、 また水平面内で出射にすることで、多様な実験に 対応できるようにした. 集光サイズは 10μm 程度 (FWHM)である. 集光システムの透過率(ミラー2 枚の反射率)は 56%であった. パルスエネルギー 10μJの EUV-FEL 光を集光した場合、そのピー ク強度は 100 TW/cm²を超える.

4.2. 同期フェムト秒レーザーシステム

EUV-FEL の短パルス性を生かした利用実験 として、フェムト秒レーザーパルスと組み合わせた ポンプ・プローブ法による時間分解計測が期待さ れている. ポンプ・プローブ法は、強力なポンプ光 により変化(励起)した状態を、プローブ光の遅延 時間を変化させて観測することで、光励起過程に おけるダイナミクスを計測する方法であり、レーザ ーパルスをポンプ光、FEL からの EUV 光をプロ ーブ光とし、光電子分光法や、吸収分光法などで、 光励起状態の電子、原子、構造の情報を得ること ができる.

EUV レーザー実験棟内に設置された光学レ ーザー用のクリーンブース内にチタンサフィアレ ーザーをベースとしたフェムト秒レーザーシステム が収容されている.このシステムは、モード同期オ シレータと増幅器から構成されている.モード同 期オシレータは、100 fs 以下のパルス列を 79.3 MHz で発生する.共振器長を制御することで、加 速器のタイミング基準RF信号に対し同期をとって



図 4. 同期レーザー導入システム

いる. 増幅器で,電子バンチのタイミングに同期した1パルスを切り出し,数mJまで増幅する. 増幅中の損傷を防ぐため,波長ごとに遅延を加えパルス幅を伸ばし,増幅後にパルス圧縮を行うチャープパルス増幅法を用いている. 発生するレーザーの波長は800 nm である. また,光パラメトリック増幅器(OPA)を用いることで近赤外~紫外領域のレーザー光を供給することも可能である.

同期レーザー光は,光学遅延器を経て EUV-FEL ビームラインにに導きかれ,集光シス テム下流に設けた同期レーザー導入用ミラーを用 いて,FEL 光に対し約 2°の角度で照射される (図4).同期レーザー光とFEL 光の照射タイミン グは,電気的な位相遅延器と光学遅延器を用い ることでそれぞれ 1 ps, 7 fsの精度で調整できる.

5. 利用の概要

EUV-FEL 利用の目的は,既述したように XFEL施設 SACLAの利用のため実験技術の研 究開発とEUV領域の新しいサイエンスの開拓で ある. SCSS 試験加速器施設の基盤整備として開 発されたパルスセレクターや同期フェムト秒レー ザー,利用推進研究で進められたコヒーレント散 乱イメージング[15]などの成果は,SACLAの基 盤整備に活かされている.一方EUV領域のサイ エンスでは,EUV-FELの光子エネルギーが,へ リウム以外の全元素のイオン化領域であり,従来 の光学レーザーで観測されてきた多光子吸収な どの非線形光学現象の過程とはまったく異なった 物理過程が生じることが期待され,新しい分野を 拓く可能性は十分にある.

利用研究は、2008 年度に開始され、公募によ り年3回(1期:4月~7月、2期:9月~12月、3 期:1月~3月)のペースで行われている.これまで の3年半(2008年度第1期~2011年度第1期) で申請課題数は 111 件あり,国内研究グループ に加えて,海外の国々(ドイツ,フランス,イタリア など)の研究グループからの申請も含まれている. 研究分野は,原子・分子科学分野,固体光物性 科学分野,イメージング分野など幅広い.とくに原 子・分子科学分野からの申請課題数は,全申請 課題数の半分以上を占めている.

これまでの SCSS 試験加速器の利用開始から 3 年間での成果として,論文発表が 30 件ある [9,14-25]. 成果内容としては,FEL光の高強度と 短パルス性を活かした非線形光学現象の観測実 験が多くを占めている.これら利用成果の1つとし て,"EUV-FEL 励起による超蛍光の観測"[9]を 後述する.

課題申請は,利用期間に合わせて年3回行われ,申請書をwebよりダウンロード,必要事項を記載.メールで受け付けている.申請された課題は,課題審査を受け,採択された場合に実施可能となる,利用に関心のある方は,是非ご連絡いただきたい[10].

6. EUV-FEL 励起による超蛍光の観測

超蛍光とは,量子光学現象の1つであり,励起 原子が蛍光を放出して脱励起する際に,"原子集 団"として振る舞う現象である[26].通常,孤立し た一つの励起原子からの自発放射(蛍光)が多数 の原子から独立に起こる場合,その強度は励起 状態の寿命に特徴付けられる指数関数的な減衰 曲線を描く.一方,超蛍光の場合には,ある遅延 時間の後に発光強度は最大となり,励起寿命より も遙かに短い時間幅を有するパルス形状の強度 曲線となる.ここで,遅延時間と時間幅は,集団で 脱励起する励起原子数 N の逆数に比例し,超蛍 光のピーク強度は N の二乗に比例する.

超蛍光の観測実験は、He 原子を試料として行 われた[9]. 1sls→1s3p 共鳴励起相当の EUV -FEL 光を高濃度のHe 原子に照射し、その1s3p→1s2s 脱励起過程にともなう蛍光(波長 = 501nm)の時間発展をガス濃度の関数としてストリ



図 5. 超蛍光のストリーク像の試料濃度依存性

ークカメラ(極めて短時間に生じる高速な光の強 度変化を計測する超高速光検出器)により計測し た. 図5にストリーク像のHeガス濃度依存性を示 す. He 原子濃度が高くなるに従い, 遅延時間が 短くなり、パルス幅も狭くなっている様子が明確に 見て取れる. 観測結果の詳細な解析により, EUV-FEL 光により励起された He 原子が, 原子 集団として蛍光を放出する,超蛍光現象が起きて いることが確認された.なお、半導体検出器による 強度測定から、入射 EUV-FEL 光強度に対する 超蛍光の変換効率は約10%と見積もられた.超 蛍光の観測は, FEL の利用研究としては現時点 までで唯一のものである. EUV 励起による超蛍光 は、今回のような可視発光のみならず、1s3p→ 1s1s 脱励起による EUV 発光においても同様の 振る舞いが観測されている. 超蛍光は, 特殊な環 境下で起こる集団的発光現象であり,条件さえ整 えば、XFEL 励起による X 線超蛍光の観測も可 能であると考えられる. SACLA の利用により, 研 究が大きく進展することが期待される.

7. おわりに

本稿では、SASE型 FELの原理とSCSS 試験 加速器施設の EUV-FEL の利用に関して簡単に 報告した. EUV-FEL の利用は、XFEL 施設 SACLA の利用機器の開発研究と EUV 領域の 新しいサイエンスの開拓を目的に行われた.利用 開始から3年経過して、機器開発では、SACLA のビームラインだけでなくユーザー実験装置など にも EUV-FEL の利用実験での経験が活かされ ているものが少なくない.一方、EUV-FEL のサイ エンスにおいても、非線形光学現象を中心にいく つもの新しい発見があり、新しい分野が展開され ていることがわかる.

XFEL施設 SACLA の利用はすぐそこまできて いる.新しいサイエンスの扉が今開こうとしている.

謝辞

本稿の執筆にあたって,理化学研究所播磨研 究所 XFEL 研究開発部門より資料を提供してい ただいた. SCSS 試験加速器の運転と保守および ビームライン整備は,理化学研究所播磨研究所 XFEL 研究開発部門エンジニアリングチームの協 力を受けている. EUV-FEL 励起による超蛍光の 観測実験は, James Harries 博士(原子力研究 機構),繁政英治准教授,岩山洋士助教(分子 研),登野健介博士,富樫格博士,大橋治彦博士, 仙波泰徳博士(JASRI)との共同研究によるもの である. ここに感謝の意を表する.

参考文献

[1] J.M.J. Madey, J. Appl. Phys. 42, 1906 (1971).

[2] R. Bonifiacio, C. Pellergrini, and L.M. Narducci, Optics Commun. 50, 373 (1984).

[3] K-J. Kim, Nucl. Instrum. Methods A 250, 396 (1986).

[4] J. Andruskow *et al.*, Phys. Rev. Lett. **85**, 3825 (2000).

[5] H. Wabnitz *et al.*, Nature **420**, 482 (2002).

[6] T. Shintake *et al.*, Nature Photonics 2, 555 (2008).

[7] T. Shintake *et al.*, Phys. Rev. Spec. Top. Accel. Beams **12**, 070701 (2009).

[8] T. Togashi *et al.*, Opt. Express **19**, 317 (2009).

[9] M. Nagasono *et al.*, Phys. Rev. Lett. **107**, 193603 (2011).

[10] http://xfel.riken.jp

[11] M. Yabashi *et al.*, Proceedings of FEL 2006, 785 (2007).

[12] T. Kudo et al., Rev. Sci. Instrum. 80,

093301 (2009).

[13] H. Ohashi *et al.*, Nucl. Instrum. Meth.A 649,163 (2011).

[14] N. Saito *et al.*, Metrologia **47**, 21
(2010); M. Kato *et al.*, Metrologia **47**, 518
(2010); M. Kato *et al.*, Nucl. Instrum.
Methods Phys. Res. A **612**, 209 (2009).

[15] Y. Nishino *et al.*, Appl. Phys. Express 3, 102701 (2010).

[16] Y. Hikosaka *et al.*, Phys. Rev. Lett. **105**, 133001 (2010).

[17] T. Sato *et al.*, Appl. Phys. Lett. **92**, 154103 (2008); T. Sato *et al.*, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. **44**, 161001 (2011).

[18] N. Miyauchi *et al.*, J. Phys. B: At. Mol.Opt. Phys. 44, 071001 (2011).

[19] H. Fukuzawa et al., J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 43, 111001 (2010); A. Yamada et al., J. Chem. Phys. 132, 204305 (2010); K. Motomura et al., J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 42, 221003 (2009); H. Fukuzawa et al., J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 42, 181001 (2009); H. Fukuzawa et al., Phys. Rev. A 79, 031201 (2009); K. Motomura et al., Nucl. Instrum. Method A 606, 770 (2009); X.-J. Liu et al., Rev. Sci. Instrum. 80, 053105 (2009).

[20] M. Yao *et al.*, Euro Phys J. Special Topics, **196**, 175 (2011); H. Iwayama *et al.*, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. **43**, 161001 (2010); K. Ngaya *et al.*, J. Electr. Spectrosc. Relat. Phenom **181**, 125 (2010); H. Iwayama *et al.*, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. **42**, 134019 (2009).

[21] S. Y. Liu *et al.*, Phys. Rev. A **81**, 031403(2010).

[22] Y. Inubushi *et al.*, Rev. Sci. Instrum.
81, 036101 (2010); H. Yoneda *et al.*, Opt. Express 17, 23443 (2009).

[23] N. A. Inogamov *et al.*, J. Opt. Tech. **78**,473 (2011); N. A. Inogamov *et al.*, Contrib.

Plasma. Phys. 51, 419 (2011).

[24] T. Shimizu *et al.*, Appl. Phys. Express
4, 062701 (2011); K. Yamanoi *et al.*, Opt. Mater. 32, 1305 (2010); T. Shimizu *et al.*, Rev. Sci. Instrum. 79, 033102 (2010).

[25] R. Bachelard *et al.*, Phys. Rev. Lett.106, 234801 (2011).

[26] R. H. Dicke, Phys. Rev. 93, 99(1954);
J. Okada *et al.*, Opt. Communications 27, 321-323 (1978);
R. G. Devoe and R. G. Brewer, Phys. Rev. Lett. 76, 2049 (2011);
E. Pradis *et al.*, Phys. Rev. A 77, 043419 (2008)

Principles of SASE-FEL and the present status of the EUV-FEL beamline at the SCSS test facility.

Mitsuru Nagaosno, Takashi Tanaka, Makina Yabashi, Hitoshi Tanaka, Tetsuya Ishikawa

The SCSS test facility is described for the benefit of present and future users. The facility provides coherent, brilliant, ultra-short pulses extreme in the ultra-violet spectral region, and is based on self-amplified spontaneous emission а free-electron laser scheme. An introduction is given to the common utilities available at the beamline, including the gas absorption attenuator, the gas ionization photo intensity monitor, the focusing mirror system, and the synchronized fs-laser system. As an example of recent research at the facility, the observation of collective spontaneous emission (superfluorescence) is described. This work hints at a method for creating monochromatic, coherent x-ray radiation pulses using an x-ray SASE-FEL.

気液界面反応機構と大気化学

薮下 彰啓 京都大学大学院工学研究科分子工学専攻 yabushita@moleng.kyoto-u.ac.jp 平成 23 年 10 月 11 日原稿受付

海洋や海塩エアロゾル上で起こる不均一反応は大気の化学組成に影響を及ぼしている.海やエアロゾル を構成する塩を含む水溶液と気体との界面で,ハロゲン化物イオンとオキシダントガスが反応し,大気中 へ活性ハロゲン種を放出すると提案されている.このような活性ハロゲン種は海洋境界層でオゾン破壊を 引き起こす.これまでの研究により,バルクとは異なる,界面での特異的な反応促進,アニオン濃縮や界 面特有の錯体の存在などが明らかになっている.本稿では,理論と実験研究などにより明らかにされつつ ある,気液界面反応機構の分子レベルでの理解について,最近の研究を紹介する.

1. はじめに

気液界面は海洋,湖,エアロゾルの境界など, 地球大気のいたるところに存在している.そこでは, ガスの取り込みや化学反応が起こり,光化学スモ ッグ,酸性雨,オゾン破壊などを引き起こし,大気 環境に大きな影響を及ぼしている.

海洋上から逆転層直下までの約1000m くらいの 間を海洋境界層(MBL:marine boundary layer)と 呼ぶ.逆転層とは高度が上がると、気温も上がる 層のことを指す.逆転層は大気のフタの様な役割 を果たし、地上や海上と逆転層の内側に大気が 閉じこめられたような状態を作り出す. MBL には 活性ハロゲンが存在し、例えば以下のサイクルに より、オゾン(O₃)破壊に関与している.

$$X(=Cl, Br, I) + O_3(g) \rightarrow XO(g) + O_2(g)$$
(1)

$$\begin{aligned} XO(g) + HO_2(g) &\rightarrow HOX(g) + O_2(g) & (2) \\ XO(g) + NO_2(g) &\rightarrow XONO_2(g) & (3a) \\ XONO_2(g) + H_2O(aq) &\rightarrow HOX(g) + HNO_3(aq)(3b) \\ HOX(g) + Y'(=CI', Br', \Gamma) + H^+ &\rightarrow XY(g) + \\ H_2O(aq) & (4) \end{aligned}$$

 $XY(g) + h\nu \rightarrow X(g) + Y(g)$ (5)

酸化ハロゲンラジカル(XO·)は O₃(g)を再生成しな

い経路でハロゲン原子に戻るため、このサイクル によって触媒的に O₃(g)を減少させる^[1].

これらの活性ハロゲン種のうち,例えば,一酸 化ヨウ素ラジカル(IO・)の主要な放出源としては, 沿岸部における海藻やバクテリアからの生物学的 放出による,揮発性有機ハロゲン化合物(CH₂I₂ など)が光分解によって生成したI原子が,O₃(g)と 反応して生成すると考えられてきた.IO・(g)は上記 (1)-(5)のサイクルによってオゾン破壊に関与する ため,重要な化学種である.海藻類は沿岸部にし か生息しないため,長年の間,IO・(g)の放出は局 地的な寄与であるとされていたが,近年,生物学 的放出のないはずである海洋上で IO・(g)が観測 された^[2].また,観測された IO・(g)は,生物由来の 有機ヨウ素化合物だけでは説明できず,これらの 結果は,何か別のヨウ素放出源がある事を示唆し ている^[3].

このような活性ハロゲン種の MBL への供給源 として考えられるのは海である.海にはハロゲン化 物イオン(Cl, Br, Γ)が存在している.また, MBL には,海塩エアロゾルと呼ばれる微粒子も存在し ている.海塩エアロゾルは,海水の泡の薄膜が半 球状に海水面に現れ,それが破裂することで生 成している.海塩エアロゾルにも,当然ハロゲン化 物イオンが含まれている. ハロゲン化物イオンが ハロゲンガスとして MBL へ放出される過程の候 補の一つとして,オキシダントガスと海洋や海塩エ アロゾルの気液界面反応が考えられる.

近年,室内実験によりその反応についての研 究がなされている. 例えば, 海塩のハロゲン化物 がヒドロキシラジカル(OH·), O₃(g)や二酸化窒素 (NO₂)のような微量大気オキシダントガスによって 活性化され,大気中に Cl2^[4], Br2^[5-7]や L2^[8,9] が放 出される反応機構が研究されている(図 1). これら のハロゲンガスは太陽光によって光分解して原子 となり,反応(1)によりオゾンを破壊する.そこで本 稿では、大気化学にとって重要な気液界面でのイ オン・分子の振る舞いと、そこで起こる化学反応機 構について最近の研究を紹介する. 室内実験に よりハロゲン化物イオンは、バルク溶液中よりも境 界層に偏析しやすい傾向を持つ事が明らかにな っている[10]. そこでまず, 2 章でハロゲン化物イオ ンが境界層で濃縮される要因についての研究を 紹介した後,3 章で気液界面でのハロゲン化物イ オンとオキシダントガスとの反応によるハロゲンガ ス生成過程について述べる.反応場である海面 は、バルクと比べ相対的に有機化合物に富んだ 領域である. 疎水基を持つ有機化合物が大気と 海水の界面に濃縮されるためである^[11]. 例えば、 海洋生物の排泄物や死骸などによる,脂肪酸,脂 肪アルコール,アミノ酸などである.この有機物に 富む海面の約1000 µm 程度の層は海洋表面ミク



図 1 有機物を含む気液界面でのハロゲン化 物イオンとオキシダントガスとの反応によるハ ロゲンガス生成過程

ロ層(SML:sea surface microlayer)と呼ばれている. そのため,海洋や海塩エアロゾルの表面はバルク と比べ,有機物やハロゲン化物イオンが豊富な状 況であると考えられる.そこで4章では,有機物が 3章で述べた反応機構に及ぼす影響について述 べる.

2. 気液境界層でのハロゲン化物イオンの濃縮

海塩エアロゾルは,海水の泡が破裂することで 生成している.しかしながら,海塩エアロゾルの化 学組成は海水のそれとは大きく異なっている.海 水中のハロゲン化物イオンは圧倒的に塩化物イ オン(Cl)が多く,臭化物イオン(Br)やヨウ化物イ オン(Cl)は極微量にしか含まれていないにもかか わらず,微小な海塩エアロゾルでは Br⁻や Γが 10-10⁴ 倍も高濃度で存在している^[12].海水が薄 膜状になったときに,化学的分別が行われたため であろうと考えられている.

エレクトロスプレーイオン化質量分析(ESI-MS) 法では液滴の表面に存在しやすいイオンが優先 的に検出される. 図2にこの方法の模式図を示す. 測定したい試料を溶媒に溶かして電圧をかけた 注射針に資料を送りこむ.この溶液をネブライザ によって噴霧すると,細かな帯電液滴が作られる. 液滴に加熱した窒素ガスで溶媒分子を蒸発させ ることで,サイズを急速に小さくする.そのうちに表 面張力に対してイオン間のクーロン反発(電気的 反発)力のほうが大きくなり,表面部分が剥がれ落 ちるようにして分裂し,さらに小さい液滴になる.こ れを繰り返していき,最終的にナノメーターサイズ の極微小液滴となりイオンが気相に放出される. このイオンを MS で測定する事により,イオンの境 界層での存在しやすさを調べる事ができる.ESI



図 2 エレクトロスプレーイオン化質量分析法の 模式図

のメカニズムの詳細については、Kebarleらの総説 を参考にされたい^[13,14].

Cheng らはこの ESI-MS 法を用いて, Br, NO₃, I, SCN, BF4とClO4のNa塩を各々0.1 mMづつ 含む水溶液を測定した[15]. 各アニオンが各々等 モル量含まれているにもかかわらず,各アニオン 信号強度は、 $Br^- \sim NO_3^- < \Gamma \sim SCN^- < BF_4^-$ < ClO₄ となった. これらの信号強度は, 各アニオ ンの境界層での相対的な存在しやすさを示して いる.この存在しやすさは、脱水自由エネルギー の増加とともに指数関数的に減少し, 陰イオン半 径の増加とともに指数関数的に増加するが,分極 率とは相関がなかった. 後年, さらに PF6と IO3を 用いて実験を行うと、脱水自由エネルギーよりも 陰イオン半径との方がよりよい相関を示すことが 明らかになった^[16]. Jungwirth と Tobias は、ハロゲ ン化ナトリウム(NaX)水溶液表界面でのハロゲン 化物イオンの振る舞いについて分子動力学シミュ レーションを行い,フッ化物イオン F は表面に出 てこないが、その他のハロゲン化物イオンは、陰イ オン半径が大きくて分極性イオンである程表面活 性である(I~>Br~>Cl~)と報告している^[17]. これらの 結果により,最初に述べた「微小な海塩エアロゾ ルで観測された陰イオン半径の大きなアニオンの 濃縮」が説明できる. 陰イオン半径の大きなアニ オンが選択的に、比較的大きな海塩エアロゾルの 境界層で濃縮されて、やがて溶媒が揮発してエア ロゾルのサイズが小さくなると、境界層に存在する アニオン同士による静電反発力が表面張力に打 ち勝ち,液滴表面層が分裂する事で微小な海塩 エアロゾルが生成しているからである. 同グルー プにより, Na₂SO₄ 水溶液における SO₄²⁻も, 二価 のアニオンのため、水和による安定化を求めて溶 液内部にとどまろうとする傾向があること[18]、水和 プロトン(H₃O⁺)などは表面活性が高いことを報告 している[19]. これらの研究結果により, 界面でのイ オンの挙動を決めている因子について徐々に明 らかになりつつあるが、まだ未解明の点も多く、研 究が進められている[20].しかし、分子動力学シミュ レーション,室内実験と観測から,ハロゲン化物イ オンについては、「>Br->Clの順で表面活性であ るという結果が得られている.以下では、この表面 偏析したハロゲン化物イオンとオキシダントガスの 反応について見て行く.

3. ハロゲン化物イオンとオキシダントガスの気液 界面反応による気相へのハロゲンガス放出

海洋や海塩エアロゾルに含まれるハロゲン化物 イオンは、 $\Gamma > Br > C\Gamma$ の順で界面に存在しやすい. これら界面に存在するハロゲン化物イオンとオキ シダントガスとの反応によるハロゲンガス生成の研 究が行われている.ここでは、OH·(g) + Cl^[4], O₃(g) + Br^{-[21]}と O₃(g) + Γ ^[22]の反応について述べ る.NO₂(g)とハロゲン化物イオンの反応について は、文献[8]と[23]を参考にされたい.

Knipping らは潮解した塩化ナトリウム(NaCl)と OH・との反応による塩素(Cl₂)生成反応について の研究を行った^[4]. 図3に簡略化した実験装置の 模式図を示す. Aerosol Generator では, NaCl 水 溶液をアトマイザーによって粒子化した後に,微 分型静電分級器によって分級した粒子をチャン バーに導入している. チャンバー内の相対湿度は 自由に制御できる. OH・(g)は, O₃(g)に 254 nm の 光を照射し,以下の反応により生成させている.

$$O_{3}(g) + h\nu \to O(^{1}D)(g) + O_{2}(g)$$
(6)
$$O(^{1}D)(g) + H_{2}O(g) \to 2OH(g)$$
(7)

生成した OH·(g)と CIの反応により気相へ放出さ れた Cl₂(g)は、大気圧イオン化質量分析装置で 測定されている. 観測された Cl₂(g)生成の結果は、 気相と液相からなる従来の化学モデルでは説明 することができなかった。そこで彼らは、表面偏



図3 エアロゾルとOH(g),もしくはO3(g)との反応 によって生成したハロゲンガスを測定する実験 装置の模式図

析した $C\Gamma_{(interface)}$ と $OH \cdot (g)$ が相互作用して界面 に中間体 $[OH...C\Gamma]_{(interface)}$ ができる反応機構を提 案し,この反応を組み込んだ速度論的モデル計 算を行う事で実験結果を再現する事ができた.

$$2OH \cdot (g) + 2Cl^{-}_{(interface)} \rightarrow 2[OH \dots Cl^{-}]_{(interface)}$$
$$\rightarrow Cl_{2}(g) + 2OH^{-}_{(interface)}$$
(8)

ここで、下付添字(interface)は中間体が界面に存 在することを意味している.後年に、同グループに より、上記反応機構で提案された水酸化物アニオ ンの存在が確認されている^[24].

Huntらは実験,分子動力学計算,速度論的モ デル計算を用いて,潮解した臭化ナトリウム (NaBr)と $O_3(g)$ との反応による,気相への臭素 (Br₂)放出について研究を行なった^[21].実験に用 いた装置は図 3 と同じである. NaBr による $O_3(g)$ 取り込みの MD 計算により, $O_3(g)$ が比較的長時 間滞在し, $O_3(g)$ と Br⁻の接触が頻繁に起こり,50 ps 程度まで続く事を明らかにした.そこで,Br⁻ (interface) と $O_3(g)$ が界面に中間体 $[O_3...Br^-]$ (interface) ができる反応機構を組み込んだ速度論的モデル 計算を行い,実験結果と一致する事を見出した. Br⁻は表面偏析しているため,Br₂(g)生成における 界面反応の寄与は,バルクと同程度であると提案 している.

$$2O_{3}(g) + 2 Br_{(interface)} \rightarrow 2[O_{3}...Br_{-}]_{(interface)}$$
$$\rightarrow Br_{2}(g) + 2O_{3}(aq) \qquad (9)$$

Sakamoto らは、キャビティーリングダウン分光 法(CRDS)を用いて、O₃(g)と Гの不均一反応によ る I₂(g)生成の研究を行った^[22].通常の高感度レ ーザー検出法では高い真空度が必要であるなど、 実際の大気環境条件とは一致しない実験条件が ほとんどであるが、CRDS を用いる事により、大気 圧条件下で、気液界面での反応により気相中に 生成したラジカルや微量生成物を直接高感度検 出することができるようになる.実験では、図 4 の 装置のチャンバーに KI 水溶液をためて、その上 部よりO₃(g)を流すことにより生成するI₂(g)とIO·(g) が直接検出された.



図4O₃(g)とΓの不均一反応測定用キャビティー リングダウン分光システムの模式図

得られた結果より図 5 に示した反応機構が提案 されている。図より、I2(g)放出メカニズムには二つ の経路がある. 一つは HOI と I, H⁺による生成で あり、もう一つは、IO₃と I、H⁺による生成である. 両経路とも、以前から提唱されている反応である. IO · (g) 放出メカニズムとしては,中間体 [IOOO⁻](interface)から IO·(g)を生成し、これが気相中 に放出されたと考えられる. この反応は IO 生成と 競合して起こるが,同時に生成する O2が不安定 なため、不利な反応であると予想される.このこと は観測された L_(g)生成量が IO·(g)よりも二桁多 かった結果と一致している. また, I2(g)の放出過 程で H⁺が反応を促進できるのに対し, IO·(g)放出 には H⁺の関与がないことが予想される. 実際に, IO·(g)生成量は酸性条件下で変化がなかったが、 I₂(g)は pH が低下するに従って生成量が増加し ている.以上より、以下の反応機構が主であると 考えられている.



図5 O₃(g)とI^(aq)の反応によるIO(g)とI₂(g)生成 機構において提案されているメカニズム

$\Gamma + O_3(g \text{ or } aq) \rightarrow [IOOO^-]_{(ii)}$	nterface) (10)
--	----------------

- $[IOOO^{-}]_{(interface)} \rightarrow IO^{-} + O_2$ (11a)
- $IOOO^- \rightarrow \rightarrow IO^{\bullet}(g) + products$ (12b)

$IO^- + H^+ \rightleftharpoons HOI(aq)$	(13)
$HOI(aq) + I + H^{+} \rightleftharpoons I_{2}(aq) + H_{2}O$	(14)
$I_2(aq) \rightarrow I_2(g)$	(15)

1章で述べたように,海洋上の I₂(g) や IO·(g)生成 源は生物由来のみでは説明できておらず,この 反応によって説明できるかもしれない.

これらの結果より、界面ではバルクと異なり、表 面偏析したハロゲン化物イオンとオキシダントガス が特異的な中間体を生成し、ハロゲン種の気相 への放出機構に大きな影響を与えている事が明 らかとなった. 続いて、実際の環境中では、ハロゲ ン化物イオンだけでなく、様々な有機物も境界層 に存在しているので、それらが界面反応にどのよ うな影響を及ぼすかについての研究を紹介する.

4. 有機物が気液界面反応に及ぼす影響

海洋表面ミクロ層,海塩エアロゾルの境界層や 河川には、多様な有機物が含まれている. 主要な 有機物として,海水表面に多く見られる脂肪酸, 脂肪アルコールや,河川近くなどで多く含まれる フルボ酸,フミン酸などが挙げられる.フルボ酸と は、植物などが微生物により分解されてできる腐 植物質のうち,酸によって沈殿しない無定形高分 子有機酸であり、フェノール様の部位やカルボキ シル基を沢山有している[11,25,26]. 境界層の有機物 はガスの液相への取り込みに影響を及ぼすため, これまでに多くの研究がなされ,総説によくまとめ られている[27-29]. ここでは、これらの総説に記載さ れていない、境界層に存在する有機物が O3(g)と Iの反応により b(g)を放出する反応機構に及ぼす 影響について最近の研究を紹介する. 有機物が 反応に及ぼす影響としては、気相 I2(g)生成の抑 制効果と増強効果が考えられる.まずは,抑制効 果が現れた系について述べる.

Reeser らは,酸性条件下における,オクタノー ルを含む Γ 水溶液と $O_3(g)$ との反応による気相と液 相の $I_2(g \text{ and } aq)$ 生成量を調べた^[9].気相 $I_2(g)$ は 吸収分光法で測定され,液相 $I_2(aq)$ も同様に吸収 分光法を用いて測定した $I_3(aq)$ の濃度から算出さ れている.液相中では,以下の平衡状態にあるた めである.

 $I^{-} + I_2(aq) \rightarrow I_3^{-}$ (16)

オクタノールを加えると全 I₂生成量は微増したが, 気相に放出される I₂(g)は約 50%減少し,その分 液相に存在する I₂(aq)が増加する変化が現れた. オクタノールは水と比べて極性が低く,界面で極 性の低い環境を作り出し, I₂(aq)や I₃ (aq)を安定 化させ,気相への放出を抑制しているためだと考 えられている.

Hayase らは、フェノール類(フェノール、クレゾ ール、メトキシフェノール)を添加したときのO₃(g)と 「の反応機構に及ぼす影響を調べた^[30].図6に、 フェノールを添加したときの[IO·(g)]と[I₂(g)]の時 間変化を示す.横軸は測定時間であり、0秒のと きにO₃(g)を暴露し始めている.破線で表わされて いるフェノールがないときに比べ、実線で表わさ れているフェノールがあるときは、[IO·(g)]と[I₂(g)] ともに、大きく減少している事がわかる.この傾向 は、pH~3 以上の範囲で全てに見られた.フェノー



図 6 O₃(g) (6.5×10^{15} molecules cm⁻³)と 5 mM NaI 溶液を pH~6(破線)と 5 mM NaI + 1 m M フェノール混合溶液を pH~6(実線)と pH~10 (灰色実線)で反応させたときに生成した(A) [IO·(g)]と(B) [I₂(g)]の時間依存(Reprinted with permission from ref. [30]. Copyright 2010, American Chemical Society)

ル存在下では, [IO·(g)]が約1割以下に, [I₂(g)]が 約4割以下に抑制された. 反応機構は図7のよう に考えられる.



図 7 フェノールを添加した Γ(aq) 水溶液と O₃(g)との反応による IO(g)と I₂(g)生成機構にお いて提案されているメカニズム

Γ,フェノール(C₆H₅OH),フェノールイオン (C₆H₅O⁻)という三つの物質が O₃(g)と反応しうる.

$\Gamma + O_3(g \text{ or } aq) \rightarrow$	[IOOO ⁻](interface)	(10)
$\Gamma + O_3(g \text{ or } aq) \rightarrow$	[IOOO ⁻](interface)	(10

$$C_6H_5O + O_3(g \text{ or } aq) \rightarrow C_6H_5O \bullet + O_3 \bullet$$
(17)
$$C_2H_2OH + O_2(g \text{ or } aq) \rightarrow \text{ products}$$
(18)

 $O_3(g)$ との反応速度定数はそれぞれ、 1.2×10^9 M⁻¹s⁻¹(Γ)、 1.3×10^3 M⁻¹s⁻¹(C_6H_5OH)、 1.4×10^9 M⁻¹s⁻¹(C_6H_5O)である^[31,32]. Гは C_6H_5OH に比べて 極めて反応性が高いため、反応当初 $O_3(g)$ は Гと 優先的に反応する. フェノールは pH~10 付近で 解離し C_6H_5O となるが、中性や酸性条件では、ほ とんどが C_6H_5OH として存在している. I_2 を生成 する過程で反応式(13)と(14)のようにプロトンを消 費するため、反応が進むと、溶液の境界層はアル カリ性になる. すると C_6H_5OH は $C_6H_5O^-$ へと解離 する.

$$C_6H_5OH \rightarrow C_6H_5O^- + H^+$$
(19)

 C_6H_5O は Iと同程度 $O_3(g)$ との反応性が高いため, 競合して $O_3(g)$ と反応する. この結果, Iと $O_3(g)$ 反 応は抑制され, [IO·(g)], [I₂(g)]ともに減少する. ク レゾールとメトキシフェノールについても同様の結 果が得られている.

次に, 増強効果が現れた系について述べる.

Hayase らは、有機酸(ヘキサン酸、オクタン酸、マ ロン酸、酢酸)を添加したときの影響を調べた^[33]. これらの酸を加えると、酸を加えなかった場合と比 較して、[I₂(g)]は増加し、[IO·(g)]にはほとんど変 化がなかった. 図 8 は、O₃(g)を暴露して始めてか ら 20 秒後の[I₂(g)]の pH 変化をプロットした図であ る. 横軸は実験前のbulk pH である. pKaの異なる ヘキサン酸(pKa~4.8)、マロン酸(pKa₁~2.9、 pKa₂~5.7)添加について実験が行われた. 酸のな いときの[I₂(g)]と比較すると、bulk pH~3 あたりから、 点線で表される pKa 付近までの範囲で[I₂(g)]の増 加が見られる. つまり、pKaの前後における酸の解 離状態の違いが、[I₂(g)]増加メカニズムの鍵にな っていると考えられる. 反応機構は図 9 のように考 えられる.

溶液の pH が pKa よりも小さいとき, 酸はほとん どが解離していない状態で存在している. 有機



図 8 O₃(g) (4.8 × 10¹⁵ molecules cm⁻³)と(A)5 mM NaI 溶液(\bullet), 5 mM NaI+ 10 mM ヘキサン酸混合溶液(\bullet), 6B)3.5 × 10¹⁵ molecules cm⁻³ O₃と5 mM NaI 溶液(\bullet), 5 mM NaI+ 10 mM マロン酸混合溶液(\blacktriangle)を反応させたときに 生成した [I₂ (g)]の pH 依存. …線は, pKa~4.8(ヘキサン酸), pKa₂~5.7(マロン酸)を 示している. (Reprinted with permission from ref. [33]. Copyright 2011, American Chemical Society)



図 9 有機酸を添加した I(aq) 水溶液と O₃(g) との反応による IO(g)と I₂(g)生成機構において 提案されているメカニズム

酸は O₃(g)と反応しにくい物質であり, O₃(g)は Iと 優先的に反応する. この反応が進行すると 反応 式(13)と(14)のようにプロトンが消費されて境界層 がアルカリ性になる. すると, 有機酸は解離し, プ ロトンを放出する. このプロトンが反応式(20)と (21)に示すように I₂(g)生成過程に供給され, [I₂(g)]は増加する.

$IO^{-} + HA \rightleftharpoons HOI(aq) + A^{-}$	(20)
$HOI(aq) + I^- + HA \rightleftharpoons I_2(aq) + H_2O + A^-$	(21)
$I_2(aq) \rightarrow I_2(g)$	(15)

オクタン酸, ヘキサン酸, マロン酸, 酢酸の順で, [I₂(g)]が増加効果が顕著であった. オクタン酸, ヘキサン酸は疎水部の長い構造をしており, 溶液 の表面に集まりやすい. 一方で, マロン酸, 酢酸 は比較的溶解しやすい有機酸である. 表面活性 な有機酸ほど効果的に I₂(g)生成量が増加してい る. これは表面反応への寄与であることを示して おり, 水溶液表面の Γと O₃(g)の不均一反応に対 し, 有機酸がプロトンを供給していることを裏づけ ている.

これらの結果より,有機物は境界層の環境を変 化させ,また反応に関与する事によって,ハロゲ ンガス放出機構に大きな影響を与えている事が 示された.

5. まとめに代えて

本稿では、大気化学に関連する気液界面反応 機構についての研究を紹介した.気液界面の物 理・化学的性質はバルクとは大きく異なり、そこで 起こる化学反応も特徴的であること、そして、これ らの界面反応が大気環境に少なからず影響を及 ぼしていることが明らかになりつつある.また、共 存する化学種がさらに反応を複雑化している事も 分かってきた.

最後に、分子線を用いた衝突実験により、大気 化学と関わりの深い気液界面反応を研究した例 を紹介して終わりにしたい. Nathanson らは、五酸 化二窒素(N₂O₅)や塩化水素(HCl)が硫酸液体の 反応について、液相にブタノールやヘキサノール を混合し、その反応に及ぼす影響について研究 を行なった^[34,35]. 分子線を回転するホイールを硫 酸溶液に浸漬して生成した液膜に照射し、散乱し た分子を四重極質量分析計で測定する手法であ る. N₂O₅(g)の分子線を衝突させると、表面に存在 するアルコール類の立体障害により N₂O₅(g)の HNO₃(g)への加水分解反応は抑制された. 一方, HCl の取り込みは、アルコールの OH 基が追加の プロトン付加サイトとして寄与するために促進され た.

本稿ではこのような気相成分測定の研究を中心 に例示したが,境界層成分を測定することも,気 液界面での不均一反応機構の解明にとって有用 な情報をもたらせてくれる、そのため、ESI-MS を 改造した装置^[36-38]や、パルス電場を用いて液滴 表面に生成したイオンを質量分析法により測定す る装置^[39]などが開発されている.実際の環境下の 反応を考えた時,ここで紹介した以外の化学種は どのような影響を与えるのか,温度を変化させると どうなるのか, 光を照射するとどのような影響があ るのか,研究すべき課題はまだ多く残されている. さらに、分子スケールでの気液界面反応機構の 理解は、大気化学だけでなく物理化学にとっても 興味深いテーマであり, 今後もさらなる発展が期 待される.本稿により,読者の皆さまが,本研究分 野に少しでも興味を持っていただけましたら望外 の幸せです.

謝辞

本論文中での著者の研究成果は,川崎昌博客

員教授(総合地球環境学研究所), 江波進一准 教授(京都大学), Agustín J. Colussi 博士, Michael. R. Hoffmann 教授(以上, カリフォルニア 工科大学)との共同研究によるものであり、ここに 感謝を申し上げたい.本稿を執筆するにあたって、 川崎昌博客員教授,江波進一准教授には有益な 助言を与えていただきました. 著者の研究成果の 一部は,倉田記念日立科学技術財団の助成を受 けて行なわれた.

参考文献

[1] B. J. Finlayson-Pitts, Anal. Chem. 82, 770 (2010). [2] K. A. Read et al., Nature 453, 1232 (2008). [3] A. S. Mahajan et al., Atmos. Chem. Phys. 10, 4611 (2010). [4] E. M. Knipping et al., Science 288, 301 (2000). [5] E. K. Frinak and J. P. D. Abbatt, J. Phys. Chem. A 110, 10456 (2006). [6] S. Enami et al., J. Phys. Chem. A 111, 8749 (2007). [7] N. W. Oldridge and J. P. D. Abbatt, J. Phys. Chem. A 115, 2590 (2011). [8] E. O'Neill and R. Z. Hinrichs, J. Geophys. Res.-Atmos. 116, 9 (2011). [9] D. I. Reeser and D. J. Donaldson, Atmos. Environ. 45, 6116 (2011). [10] S. Ghosal et al., Science **307**, 563 (2005). [11] J. I. Hedges and J. M. Oades, Org. Geochem. 27, 319 (1997). [12] R. A. Duce and E. J. Hoffman, Annu. Rev. Earth Planet. Sci. 4, 187 (1976). [13] P. Kebarle and L. Tang, Anal. Chem. 65, A972 (1993). [14] P. Kebarle and U. H. Verkerk, Mass Spectrom. Rev. 28, 898 (2009). [15] J. Cheng et al., J. Phys. Chem. B 110, 25598 (2006). [16] J. Cheng et al., J. Phys. Chem. B 112, 7157 (2008).

[19] M. Mucha et al., J. Phys. Chem. B 109, 7617 (2005).[20] C. D. Wick and O. T. Cummings, Chem. Phys. Lett. 513, 161 (2011). [21] S. W. Hunt et al., J. Phys. Chem. A 108, 11559 (2004). [22] Y. Sakamoto et al., J. Phys. Chem. A 113, 7707 (2009). [23] A. Yabushita et al., J. Phys. Chem. A 113, 4844 (2009). [24] A. Laskin et al., Science **301**, 340 (2003). [25] J. Ephraim et al., Environ. Sci. Technol. 20, 354 (1986). [26] J. A. Leenheer and J. P. Croue, Environ. Sci. Technol. 37, 18A (2003). [27] D. J. Donaldson and V. Vaida, Chem. Rev. 106, 1445 (2006). [28] C. E. Kolb et al., Atmos. Chem. Phys. 10, 10561 (2010). [29] P. Davidovits et al., Chem. Rev. 111, PR76 (2011). [30] S. Hayase et al., J. Phys. Chem. A 114, 6016 (2010). [31] J. Hoigne and H. Bader, Water Res. 17, 173 (1983). [32] J. Hoigne and H. Bader, Water Res. 17, 185 (1983). [33] S. Hayase et al., J. Phys. Chem. A 115, 4935 (2011). [34] G. M. Nathanson, Annu. Rev. Phys. Chem. 55, 231 (2004). [35] S.-C. Park et al., Accounts Chem. Res. 42, 379 (2009). [36] S. Enami et al., Chem. Phys. Lett. 455, 316 (2008).

[17] P. Jungwirth and D. J. Tobias, J. Phys. Chem.

[18] S. Gopalakrishnan et al., J. Phys. Chem. B109,

B 105, 10468 (2001).

8861 (2005).

[37] S. Enami et al., J. Phys. Chem. A 114, 5817 (2010).

[38] 薮下彰啓他, エアロゾル研究 26, 214
(2011)
[39] H. I. Kim et al., J. Am. Chem. Soc. 132, 2254
(2010)

Reaction mechanisms at the air/water interface in atmospheric chemistry

Akihiro Yabushita

Heterogeneous reactions involving sea water and sea salt aerosols influence the chemical composition of the atmosphere. The reactions of halogen anions with oxidant gases at the interface between the air and the salt solution, which is comprised of the sea and aerosol particles, have been proposed to be responsible for the release of reactive halogens into the atmosphere. Reactive halogens deplete ozone in the marine boundary layer. Previous studies partly revealed unexpected features of gas-liquid interactions including enhanced reactivity, the presence of surface complexes and an enhanced anion concentration, which don't occur in bulk solutions. Here, I review recent progress for molecular-level a understanding of reaction mechanisms at the air/water interface using theoretical and experimental studies.

衝突論ノート

VIII.低エネルギー衝突でも摂動論
- たかがボルン近似,されどボルン近似 -

島村 勲

理化学研究所原子物理研究室

shimamur@ribf.riken.jp

平成 23 年 10 月 19 日 原稿受付

1 結構やっかいなボルン近似

高エネルギー散乱の表題の下にボルン近似を 説明する教科書があります.これは誤った印象 を与えます.低エネルギー衝突に使うと,簡単 に計算できるからとひどいことをするとか,そ れで良い結果が出ればたまたまさと即座に片付 ける,そんな短絡的な考えでは大間違いを犯し かねません.尤も,実験値を良く再現する近似を やみくもに信仰するのも同じ穴のむじなですが.

ボルン近似は単なる1次摂動論です.散乱振幅などをポテンシャルにつきべき級数展開した, いわゆるボルン級数の初項に過ぎません.この 級数が収束し,初項だけでほぼ再現できるぐら いにポテンシャルの効果が弱ければ良いのです. 別に,高エネルギー衝突の条件が必須ではあり ません(第6,7節).低エネルギー散乱でボルン 級数が収束する条件も導けます(第8節).

逆に,高エネルギー衝突でもボルン級数が発 散すれば論理的にボルン近似は破綻します.ラ ザフォード断面積を再現するクーロン散乱のボ ルン近似も,実はそういう,理論的根拠のない 近似なのです(第8節).高エネルギーになると1 次ボルン近似に2次の項が打ち勝つ奇妙な例も あります(第8節).衝突エネルギーに拘わらずボ ルン断面積がゼロで使い物にならない過程もあ ります(第8節).単純なようで結構やっかいなこ とが多々あるのがボルン近似,ボルン級数です.

今回はまず物理的解釈に注意を払いながらボ ルン近似の入門的解説にかなりの誌面を割き(第 2-5節),その後,いくつかの話題を紹介します.

2 ポテンシャル散乱のボルン近似

量子力学の摂動論ですから,考えている物理 系のハミルトニアン H を基本部分 H_0 と弱い摂 動 H' に $H = H_0 + H'$ と分解します.ポテンシャ ル散乱,つまりポテンシャル場 $V(\mathbf{r})$ による質 量 μ の粒子の散乱なら,運動エネルギー演算子 $T = -(\hbar^2/2\mu)\Delta_{\mathbf{r}}$ を H_0 として選び, $V(\mathbf{r})$ を摂 動として扱いましょう.また,相対距離ベクト ル \mathbf{r} に依る相互作用 $V(\mathbf{r})$ を及ぼし合う二つの 粒子間の弾性衝突なら,換算質量を μ として, 相対運動エネルギー演算子 $T = -(\hbar^2/2\mu)\Delta_{\mathbf{r}}$ を H_0 とし, $V(\mathbf{r})$ を摂動とします.

無摂動状態(Tの固有関数)の平面波 exp(*i*k·r) から別の平面波 exp(*i*k'·r) への遷移を考えます. r に関する運動の運動量ベクトル変化(図1)

$$\hbar \mathbf{q} = \hbar \mathbf{k} - \hbar \mathbf{k}' \tag{1}$$

を入射粒子からポテンシャル場への,または2粒 子間の相対運動から内部運動への移行(移動)運 動量と呼びます[1].非弾性衝突でも同じです.仲 間内では momentum transfer の語順通り「運動 量移行」と呼んでいます. \hbar は本質的でないので, 以下,波数と運動量を区別せずに説明します.始 め k 方向に,そして遷移(散乱)後には k'方向に 運動するので,ベクトル k,k'の間の角度が散 乱角 θ で,弾性散乱 $k' = |\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}| = k$ では

$$q = 2k\sin(\theta/2) \tag{2}$$

と書けます.前方運動量損失割合 q_{\parallel}/k ,つま り移行運動量ベクトル q の初期運動方向成分 $q_{\parallel} = k - k' \cos \theta$ (図1)の k に対する比を角分布 $d\sigma/d\omega$ で平均すれば前方運動量移行断面積

$$\sigma_m = \int \left(\frac{q_{\parallel}}{k}\right) \frac{d\sigma}{d\omega} d\omega = \int \left(1 - \frac{k'}{k}\cos\theta\right) \frac{d\sigma}{d\omega} d\omega \quad (3)$$

が得られます.弾性散乱ならk'/k=1です.



図1.入射波,散乱波の運動量と移行運動量 q.

運動量が $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}'$ と変わるポテンシャル散乱の 微分断面積 $d\sigma(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}')/d\omega$ は摂動 $V(\mathbf{r})$ による平 面波間の遷移確率に比例します .1 次摂動論では

$$\frac{d\sigma^{\rm B}(\mathbf{k} \to \mathbf{k}')}{d\omega} = |f^{\rm B}(\mathbf{k} \to \mathbf{k}')|^2, \qquad (4)$$

$$f^{\rm B}(\mathbf{k} \to \mathbf{k}') = C_a(e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}|V(\mathbf{r})|e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}) \quad (5)$$

$$= C_a \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} V(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \qquad (6)$$

と表せ,散乱振幅 $f^{\mathrm{B}}(\mathbf{k}
ightarrow \mathbf{k}')$ の係数は

$$C_a = -\mu/(2\pi\hbar^2) \tag{7}$$

となることが理論的に導けます [1-3].

式 (5) で $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ の替りに散乱の効果を含む正し い波動関数 $\psi(\mathbf{r})$ を使えば正しい散乱振幅が得ら れます [1–3].逆に,その正しい式で $\psi(\mathbf{r})$ を無摂 動の $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$ で近似したのが $V(\mathbf{r})$ の1次まで正しい 散乱振幅の近似式(5),(6) だと言えます. $\psi(\mathbf{r})$ を 摂動展開して $V(\mathbf{r})$ の n-1次まで取り入れれば n次まで正しい第n次ボルン近似の散乱振幅を得 ます.式(5),(6) は第1次ボルン近似,略してボ ルン近似,また平面波ボルン近似とも呼びます.

ポテンシャル $V(\mathbf{r})$ の漸近形がクーロン型なら, H_0 としてクーロン相互作用下でのハミルトニア ンを使い,残りの短距離型ポテンシャル $v(\mathbf{r})$ を H'と扱うべきです.それを無摂動のクーロン波 動関数二つで挟み積分すれば, $v(\mathbf{r})$ についての 1次摂動近似,クーロン波ボルン近似を得ます.

 $V(\mathbf{r})$ をC倍すれば散乱振幅(6)もC倍,断面積 (4)は C^2 倍され $V(\mathbf{r})$ の符号に依りません.第2 次ボルン近似の散乱振幅は $V(\mathbf{r})$ の1次と2次の 項の和なので微分断面積はその交差項, $V(\mathbf{r})$ の 3次項を含み, V(r)の符号に依存します.次節 で述べる一般の散乱問題でもこの事情は同じな ので,相互作用の符号が反転する電子衝突と陽 電子衝突の直接過程の断面積がある衝突エネル ギー以上で一貫して等しくなるならば,そこでは 1次ボルン近似が成立していると推定されます.

微分断面積は一般に散乱エネルギー Eと散乱 角 θ の2変数関数ですが,ポテンシャル $V(\mathbf{r})$ が球 対称ならボルン近似(4)はqにしか依りません. 各Eでの微分断面積をqの関数として描けば, ボルン近似が成り立つ限り,一つの普遍曲線に 乗ります.逆に,普遍曲線に乗ることが確認さ れればボルン近似の成立が推定できます.

式 (6) は定数係数を除き相互作用 $V(\mathbf{r})$ のフー リエ変換です.ボルン散乱振幅の本質は相互作 用の運動量表示なのです.フーリエ逆変換した $V(\mathbf{r})$ の運動量分布の各 \mathbf{q} 成分が移行して散乱 $\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}' = \mathbf{k} - \mathbf{q}$ を起こし,この運動量分布に 比例した散乱振幅 $f^{\mathrm{B}}(\mathbf{k} \rightarrow \mathbf{k}')$ を生じます.

例えば電荷 ze, Ze間のクーロンポテンシャル なら,そのフーリエ分解(複号はどちらでも同じ)

$$V_{\rm C}(r) = \frac{zZe^2}{r} = \frac{zZe^2}{2\pi^2} \int e^{\pm i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} p^{-2} d\mathbf{p} \qquad (8)$$

を式 (6) に代入し,本シリーズ第1回[4] に述べ た平面波間の「正規直交」関係の3次元版

$$(e^{i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}}, e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}) = (2\pi)^3 \delta(\mathbf{q} - \mathbf{p})$$
 (9)

を使えば $\mathbf{p} = \mathbf{q}$ の成分だけが抽出され,

$$f^{\rm B}(\mathbf{k} \to \mathbf{k}') = C_a \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} V_{\rm C}(r) d\mathbf{r}$$
$$= \alpha \int \left[(2\pi)^{-3} \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} e^{-i\mathbf{p}\cdot\mathbf{r}} d\mathbf{r} \right] p^{-2} d\mathbf{p}$$
$$= \alpha \int \delta(\mathbf{q} - \mathbf{p}) p^{-2} d\mathbf{p} = \alpha/q^2, \qquad (10)$$

$$\alpha = -2\mu z Z e^2 / \hbar^2 \tag{11}$$

となります(実は,フーリエ変換と逆変換の関係 を導いたに過ぎません).式(10)は実数なので位 相は間違いですが,ラザフォード断面積を再現し ます[5].これには相互作用の長距離性から諸々 の議論がありますが,教科書[2]はこれを全くの 偶然と断じます(第8節).なお,短距離型ポテン シャルが混じるとその効果との干渉を表す上で クーロン散乱振幅の位相の誤りは深刻です.同 種粒子同士の衝突でもこの位相の誤りが本来は 顕著な干渉効果を失わせてしまいます[5].

3 非弾性過程のボルン近似

電子,陽電子,陽子,反陽子,裸の原子核などの 単一粒子と中性原子との衝突で起こる励起,脱 励起過程を考えます.入射粒子と標的原子の相 互作用 $V(\mathbf{r},\mathbf{r}_t)$ は原子核-入射粒子間の相対座標 \mathbf{r} と原子内諸電子の座標(すべて含めて一つの文 字 \mathbf{r}_t で表します)との関数ですが,これを摂動 として扱います.無摂動系は状態nにある孤立 原子 $\phi_n(\mathbf{r}_t)$ と,それと相互作用せずに自由運動 をする相対運動の平面波 $\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r})$ です.両方 の運動が独立なら全体の波動関数は両方の波動 関数の積です.したがって,前節と同様に1次摂 動論から次の平面波ボルン近似が得られます:

$$\frac{d\sigma^{\rm B}(n\mathbf{k} \to n'\mathbf{k}')}{d\omega} = \frac{k'}{k} |f^{\rm B}(n\mathbf{k} \to n'\mathbf{k}')|^2, \quad (12)$$

$$f^{\rm B}(n\mathbf{k} \to n'\mathbf{k}')$$

$$= C_a(\phi_{n'}(\mathbf{r}_t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}|V(\mathbf{r},\mathbf{r}_t)|\phi_n(\mathbf{r}_t)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}})$$
(13)

$$= C_a \int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}} \mathcal{V}_{n'n}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}, \qquad (14)$$

$$\mathcal{V}_{n'n}(\mathbf{r}) = \int \phi_{n'}^*(\mathbf{r}_t) V(\mathbf{r}, \mathbf{r}_t) \phi_n(\mathbf{r}_t) d\mathbf{r}_t.$$
 (15)

状態 n から n' への遷移を起こす有効ポテンシャ ル $\mathcal{V}_{n'n}(\mathbf{r})$ についての1次摂動近似(6)という物 理的意味を式 (14) は表し,その本質は $\mathcal{V}_{n'n}(\mathbf{r})$ の運動量表示で,移行運動量ベクトル q だけの 関数になります.さらに標的がランダムな向き を向いていればこれにつき平均すると q の大き さ q だけの1 変数関数になります [6].

入射粒子にも内部構造があれば,その初期状態 と終状態の波動関数をそれぞれ $\phi_n(\mathbf{r}_t)$, $\phi_{n'}(\mathbf{r}_t)$ に掛けておけばその遷移も同時に扱えます.

ここまでは相互作用の具体形について何も指定しておらず、ごく一般的な話です.変数 \mathbf{r}_t や波動関数 $\phi_n(\mathbf{r}_t)$ の定義を適切に変更すれば、原子標的に限らず、例えば断熱近似が妥当な分子の振動状態遷移,回転状態遷移や、電子・振動・回転運動が結合した断熱近似なしの分子状態間の遷移にも使えます.もちろん、原子系、分子系に限らず、一般の量子論的散乱の摂動論です.

式(14)は \mathbf{r}_t 積分(15)を先に行った結果です. しかし,荷電粒子衝突による原子や分子の電子状態遷移では,つまり標的との全相互作用が個々のクーロン相互作用の和である限り,逆に \mathbf{r} の積分を先に行うと別の物理的意味が見えてきます.

4 荷電粒子による電子状態遷移

ある標的内電子の座標を \mathbf{r}_i , これと電荷 zeをもつ入射粒子との相対距離ベクトルを \mathbf{x}_i = $\mathbf{r} - \mathbf{r}_i$ とし, その間に働くクーロン相互作用 $V_{\rm C}(x_i) = -ze^2/x_i$ につき,一旦固定した \mathbf{r}_i を原 点に選び直して,つまり積分変数を \mathbf{r} から \mathbf{x}_i に すり替えて式(13)(のうち電子iに関するポテン シャルの項)に含まれる \mathbf{r} 積分を行います. 被積 分関数に $1 = e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i}e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i}$ を掛けると

$$C_{a}(e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}}|V_{\mathrm{C}}(x_{i})|e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}})_{\mathbf{r}} = C_{a}\int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}V_{\mathrm{C}}(x_{i})d\mathbf{r}$$
$$= C_{a}e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_{i}}\int e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}_{i}}V_{\mathrm{C}}(x_{i})d\mathbf{x}_{i}$$
(16)

を得ますが,すでに式(10)で求めてあるフーリ 工変換に基けば, $(\alpha/q^2)e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i}$ となります.変数 rで積分したので相対運動の平面波 $e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}$ が消え るのは当然ですが,替りに標的内電子に関する $e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i}$ が現れたことがポイントです(次節).

残った仕事は式(16)を標的内全電子 i につき 加え合わせることと, $\phi_{n'}^*(\mathbf{r}_t)\phi_n(\mathbf{r}_t)$ を掛けて \mathbf{r}_t で(すべての \mathbf{r}_i で)積分することで,結局,

$$f^{\mathrm{B}}(n\mathbf{k} \to n'\mathbf{k}') = (\alpha/q^2) \epsilon_{n'n}(\mathbf{q}) \quad (n' \neq n), \quad (17)$$
$$\epsilon_{n'n}(\mathbf{q}) = \left(\phi_{n'} \left| \sum e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}_i} \right| \phi_n \right) \quad (18)$$

を得ます [3,6]. ただし,式(11)の α で, Z は電 子なので -1です.入射粒子と標的原子核の相 互作用を落しましたが, $n' \neq n$ の場合に話を限 れば,その \mathbf{r}_t 積分が $\phi_{n'}(\mathbf{r}_t) と \phi_n(\mathbf{r}_t)$ の直交性か らゼロになり,この相互作用は効きません.

散乱振幅(17)は二つの因子をもちます.一つ は個々の標的内電子によるクーロン散乱振幅 (10)で,これは原子構造に依りません.もう一 つはクーロン散乱により運動量qが標的内電子 に移るとき標的が遷移 $n \rightarrow n'$ を起こす遷移振幅 $\epsilon_{n'n}(\mathbf{q})$ で,非弾性散乱形状因子と呼ばれます. 標的のランダムな向きにつき平均すれば $\epsilon_{n'n}$ は qの大きさqだけの関数になり,微分断面積は

$$\frac{d\sigma^{\rm B}(n\mathbf{k}\to n'\mathbf{k}')}{d\omega} = \left(\frac{k'}{k}\right)\frac{\alpha^2}{q^4}|\epsilon_{n'n}(q)|^2 \quad (19)$$

と表せます.一定散乱角 θ では,衝突エネルギー Eが高くなれば $q^4 \propto E^2$ と言えまず(図1). 微分 断面積は一般に $E \ge \theta$ の関数なのに,ボルン近 似では、速度比k'/kを除き)1変数qだけの関数に なることはポテンシャル散乱と同じ事情です.

5 一般化振動子強度と非ボルン定理

qが小さいとき式(18)で $e^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i} \simeq 1 + i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}_i$ が使え,また1の積分は状態n,n'間の直交性で消え,

$$\lim_{q \to 0} \left| \frac{\epsilon_{n'n}(q)}{qa_0} \right|^2 = \left| \left(\phi_{n'} \left| \sum \frac{z_i}{a_0} \right| \phi_n \right) \right|^2 \quad (20)$$

を得ます.ボーア半径 a_0 を入れ,全体を無次元量 にしました. z_i は電子iの座標成分で,電子と電 磁波の相互作用を決める双極子モーメント $-ez_i$ に比例するので,式(20)の右辺にリュードベリ 単位R(=13.6 eV)の遷移エネルギー $\Delta E_{n\to n'}/R$ を掛けると双極子振動子強度(dipole oscillator strength, DOS) $f_{n\to n'}$ になります[3,6].そこで 1変数qだけの関数である一般化振動子強度 (generalized oscillator strength, GOS)

$$F_{n \to n'}(q) = \frac{\Delta E_{n \to n'}}{R} \left| \frac{\epsilon_{n'n}(q)}{q a_0} \right|^2$$
$$= \left(\frac{k}{k'}\right) \left(\frac{q}{\alpha a_0}\right)^2 \frac{\Delta E_{n \to n'}}{R} \frac{d\sigma^{\mathrm{B}}(n\mathbf{k} \to n'\mathbf{k'})}{d\omega} \quad (21)$$

を定義すると , その極限が DOS になります : $\lim_{q\to 0}F_{n\to n'}(q)=f_{n\to n'}. \tag{22}$

光学的禁制遷移ではこの極限は当然ゼロです.

GOS も DOS と同様無次元量です.また DOS を連続状態を含め全終状態 n' に亘り加えれば原 子内電子数 N_e になるというトーマス-ライヒェ-クーン(Thomas-Reiche-Kuhn, TRK)総和則を GOS へ拡張したベーテ(Bethe)総和則

$$\sum_{n'} F_{n \to n'}(q) = N_e \tag{23}$$

が各qの値につき成り立ちます[6].

ボルン近似が成り立つかどうかに拘わらず, GOS の式(21)中でボルン近似微分断面積の代 リに精確と思われる微分断面積を使って得られ る $\mathcal{F}_{n \to n'}(q, E)$ を「見かけの」一般化振動子強度 (apparent GOS)と呼びます.これは一般に相 対運動エネルギーEと散乱角 θ ,またはEと移 行運動量qの2変数関数です.しかし,高エネル ギー領域で $\mathcal{F}_{n \to n'}(q, E)$ がEに依らないqの普 遍関数になれば,これが本当のGOS $F_{n \to n'}(q)$ に一致し,ボルン近似が成り立つと推論してよ いでしょう.その意味で, $\mathcal{F}_{n \to n'}(q, E)$ は理論計 算を全く使わずに測定結果だけに基づいてボル ン近似の妥当性を推定できる便利な道具です. 見かけの GOS には驚くべき性質があります [6,7].ボルン近似が成り立たないどんな低エネ ルギーEでも,ラセター(Lassettre)の定理[7]

$$\lim_{q \to 0} \mathcal{F}_{n \to n'}(q, E) = f_{n \to n'} \tag{24}$$

が保証されるのです.ボルン近似が成立するか どうか気にせずに測り易いエネルギーで微分断 面積を決めれば,極限操作で DOS が,そして 光吸収断面積が得られるのです.

ただ,式(22)でも(24)でも,極限 $q \rightarrow 0$ は現実 にはあり得ません.非弾性散乱で極限 $\theta \rightarrow 0$ で の qの最小値は,図1とエネルギー保存則から

$$q_{\min} = |k - k'| = \frac{2\mu}{\hbar^2} \frac{|\Delta E_{n \to n'}|}{k + k'} > 0 \qquad (25)$$

となり,決してゼロになりません. $q \rightarrow 0$ は関数 形を維持しながらの数学的操作に過ぎません.



図 2. ラセター定理の誤った応用例 .禁制遷移の みかけの一般化振動子強度 $\mathcal{F}_{n \to n'}(q, E)$ が移行 運動量 q の仮想領域に極大をもてば物理的領域 での実測値を点線のように外挿できない. 一般 化振動子強度 $F_{n \to n'}(q)$ でもこれは起こり得る.

光学的禁制遷移で $q \rightarrow 0$ とともに $\mathcal{F}_{n \rightarrow n'}(q, E)$ がゼロに近づく振舞が図2のようにq < |k - k'|(仮想領域)で初めて現れる場合,実現できるqの 範囲内(物理的領域)での値を破線のように外挿 すれば許容遷移と誤判断してしまいます.許容 遷移でも,仮想領域での $\mathcal{F}_{n \rightarrow n'}(q, E)$ の形によっ ては物理的領域での情報だけから決めた極限値 は間違いかも知れません . GOS $F_{n \rightarrow n'}(q)$ につ いても同じ注意が必要です.小さなqに鋭いピー クをもち、それより大きなgでしか実測値がなけ れば誤った外挿を行いかねない許容遷移,禁制 '遷移のGOSの実例が文献[8]などに見られます. ただ,式(25)によれば,電子,陽電子等の軽い粒 子が励起しきい値よりかなり高いエネルギーで 衝突するときには q_{\min} は小さく, 小角まで測定 すれば多くの場合,極限操作が信頼できます.

なお,近似的には禁制遷移のように見えても, 正確には許容遷移になる例がいろいろあります. 例えば,式(20)右辺の双極子演算子は1電子演算 子なので,1光子過程では1電子しか励起,脱励 起できません.でも,実際には原子や分子の独 立電子近似からのずれ,電子相関効果により2 電子励起配置が光学的許容状態に混じり,2電 子励起が起こり得ます.この事情はやはり1電 子演算子である e^{iq.ri} についても同じで,非弾 性散乱形状因子(18)で標的波動関数に電子相関 効果を入れて初めて2電子励起を起こせます.

光学的許容状態が相対論補正で禁制状態に混 じったり,分子の振動運動と電子運動が絡み合っ て(振電結合,vibronic coupling)混じることも あります.GOSのq依存性にも,禁制遷移らし く極大をもつ形と許容遷移的前方増大型が共存 することもあります.そんな場合でも, $q \rightarrow 0$ で 光学極限に近づく一般則は当然破れません.

6 低エネルギー電子-分子衝突

低エネルギー電子または陽電子と中性極性分子(双極子モーメントベクトルD)との散乱を考えます.相互作用は漸近的に双極子相互作用

$$V(\mathbf{r}) \sim V_d(\mathbf{r}) = \mp e \mathbf{r} \cdot \mathbf{D} / r^3$$
 (26)

になります.rは分子の重心から測った入射粒子 の位置ベクトル,複号は電子なら負,陽電子な ら正です.これは非常に長距離型のポテンシャ ルで,分子から遠く離れた道筋をゆっくり通る 粒子(遠方衝突)でもすそ野部分の弱い相互作用 によりわずかに散乱されます(図3).この弱い 小角散乱は摂動論で良く近似されるはずです.

双極子相互作用(26)は分子の向きに依るので, これを受ければ分子は回転運動を変化させます. 2原子分子か線形分子ならその回転状態(j,m)は 線形回転子,つまり球面調和関数 $Y_{jm}(\Theta, \Phi)$ で表 せるのでそれを回転遷移の始状態,終状態とし てポテンシャル(26)とともに遷移ポテンシャル $\mathcal{V}_{j'm',jm}(\mathbf{r})$ の式(15)に代入し(\mathbf{r}_t が(Θ, Φ)に, ϕ_n が Y_{jm} に対応),それに基づき散乱振幅(14)を計 算します.縮退回転副準位mを区別しなければ, $d\sigma^{\rm B}(i \rightarrow i') = 4/k'$ 、 $i = (D/eao)^2$

 $\frac{d\sigma^{\rm B}(j \to j')}{d\omega} = \frac{4}{3} \left(\frac{k'}{k}\right) \frac{j_{>}}{2j+1} \frac{(D/ea_0)^2}{q^2} \delta_{j',j\pm 1} (27)$ が得られます [9]. ここで $j_{>} = \max(j,j')$ です.

双極子相互作用による1次摂動なので,回転量子 数変化 Δj が ± 1 の非弾性遷移だけ許されます. NH₃分子のような対称コマでは,励起回転準位 に限り回転弾性散乱も起こります.

注意すべきは角度依存性 q^{-2} です.小角散乱, 遠方衝突ほどその幾何学的面積が増え,弱い散 乱でも多く寄せ集めた結果,微分断面積が大き くなります.大きな断面積が強い散乱を意味す るわけではなく,これはボルン近似が破れる理由 になりません.なお,非弾性散乱なので $\theta \rightarrow 0$ で もqはゼロでない最小値 q_{\min} に近づき(第5節), 断面積は発散しませんが,回転準位間隔は非常 に狭いので q_{\min} は小さく, $\theta \rightarrow 0$ で巨大断面積 になります.励起状態にある対称コマなら弾性 散乱で $q \rightarrow 0$ となり,また依存性 q^{-2} は線形回 転子と共通なので,微分断面積も積分断面積も 発散します.これはボルン近似の欠陥によるも のではなく,厳密な散乱解でも起こる発散です.



図 3. 極性分子による電子や陽電子の散乱.分子内を通る近接衝突・大角散乱と双極子相互作用のすそを通る遠方衝突・小角散乱を示す.



図 4. 低エネルギー電子衝突による極性分子の 回転遷移:換算移行運動量に対する換算微分断 面積.記号:2種類の実験手法による3分子の結 果.-・-:相互作用(26)による1次ボルン近似. ---:近似的に高次項を入れた結果.

強い極性をもつ3種の分子による*E* = 1.8~20 eVの電子の散乱を電子エネルギー損失分光法と 分子線の反跳を観測する方法により測った結果 を換算移行運動量に対する換算微分断面積として図4に示します.こうするとDやEの異なるボルン断面積(27)を一つの普遍曲線で表せます. 測定不可能な極端に前方の散乱以外,k' = kと言えるからです.またこのとき終状態j'につき加えた断面積は(式(27)もそうですが)一般に始状態jに依らず,気体分子が多くのjに分布していることを気にせずに測定値とボルン近似を比較できます.実験値は小角ではボルン近似の一点鎖線に乗り, θ が増えると高次項を近似的に取り入れた実線に沿っています.

7 低エネルギーしきい則

しきいエネルギー $E_{\rm th}$ をもつ励起過程で,励起後の入射粒子と標的との相対運動で許される最小角運動量量子数を l'とすると,相互作用が短距離型なら,励起後の相対運動エネルギー $E - E_{\rm th}$ が小さい領域では,この過程の断面積は

$$\sigma \propto (E - E_{\rm th})^{l' + 1/2} \tag{28}$$

と書けるいうウィグナーのしきい則(threshold law)が導けます[10].「ウィグナーが導いた」しき い則だとしてある教科書もあります.でも,必ず 引用される原論文[10]には,これは周知の事実 で多くの論文に示されていると書いてあり,誰 が最初に導いたかはっきりしません.

ウィグナー則 (28) によれば $E - E_{th}$ が小さけ れば断面積は小さいので,低エネルギーにも 拘わらず摂動近似が成立します.そこでボルン 近似 (13) で平面波 $e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$, $e^{i\mathbf{k}'\cdot\mathbf{r}}$ を部分波分解し, 球ベッセル関数 $j_l(kr)$, $j_{l'}(k'r)$ で表される部分 波で $k'r \propto (E - E_{th})^{1/2}r$ が小さいときの主要項 $j_{l'}(k'r) \propto (k'r)^{l'}$ を使います.相互作用 $\mathcal{V}_{n'n}(\mathbf{r})$ が短距離型なら \mathbf{r} での積分は有限範囲内でだけ 重要なので, k'が非常に小さければ十分小さい k'rしか積分 (13) に効かないからです.すると散 乱振幅の部分波成分 (l', l) は

 $f_{l'l}^{\rm B} \propto \int_0^\infty (k'r)^{l'} j_l(kr) \, \mathcal{V}_{n'n}(\mathbf{r}) r^2 dr \propto k'^{l'} \quad (29)$

と分かります.最小のl'の項が主要項なので,励 起断面積は $(k'/k)|f|^2 \propto k'^{(2l'+1)}$ と書け,式(28) がボルン近似により再現されました.

なお,ウィグナー則の長距離力への修正版も ボルン近似を使って導かれています[11].

8 ボルン級数が収束しない

ボルン近似の成立条件,ボルン級数の収束条 件の厳密な議論は難しい問題ですが,ポテンシャ ル散乱での簡単な物理的考察例があります[2]. 断面積や散乱振幅を直接調べるのを避け,波動 関数 $\psi(\mathbf{r})$ の平面波からのずれが小さければ $\psi(\mathbf{r})$ のボルン級数が収束し,散乱振幅も収束するは ずという十分条件の議論です.強さ $\sim V_0$,到達 距離 $\sim a$ の短距離型ポテンシャルならば,

低エネルギー散乱の場合: $V_0 a^2/(\hbar^2/\mu) \ll 1$, 高エネルギー散乱の場合: $V_0 a^2/(\hbar^2/\mu) \ll ka$

が導けます[2].低エネルギー散乱での条件が出るのが興味深いことです.この条件はエネルギーに依りません.高エネルギー散乱の方は,高いほど良いという常識的な条件です.ただ,これらはもちろん必要条件とは違います.

1次ボルン断面積がゼロになり,いかに高エ ネルギーでも何の役にも立たない例があります. 電子と陽電子の束縛系,ポジトロニウム Ps の原 子による散乱です.電子-陽電子間距離ベクトル $\mathbf{r}_{e^-e^+}$ を反転すると2粒子が入れ替り,原子との 相互作用は符号が逆転するので,この反転に対 するパリティが同じ Ps 状態間の遷移($\Delta l =$ 偶数, 遷移なしも含む)では式(15)に相当する $\mathbf{r}_{e^-e^+}$ 積 分が選択則によりゼロになるのです. $\Delta l =$ 奇数 の非弾性散乱はボルン近似でも起こります.

平面波ボルン近似がラザフォード断面積を再 現するのは全くの偶然だという教科書[2]の主張 (第2節)に戻ります.その根拠は,2次ボルン近 似の段階で既に発散するのでボルン級数に意味 がないということです.そもそもポテンシャル がクーロン型漸近形をもてばいかに遠方でも波 動関数は決して平面波に近づかないのに,平面 波を無摂動波動関数とするボルン近似には論理 的妥当性がありません.でも,この驚くべき偶 然が物理学の歴史を支配してきたのです[5].

イオン-原子,イオン-イオン衝突で漸近的クー ロンカの効果を無摂動状態に含めないと2次摂 動項が発散することは1960年代には知られて いました.しかし,80年代になり,多くの実験 値を良く再現するともてはやされていたstrongpotential Born(SPB)近似はクーロン場を正当 に扱っておらず,実は正確に計算すればそこに 含まれる2次摂動項のために発散するのに,近 似計算で尤もらしい値を出しているという指摘 が出て,ことの重大さが再認識されました[12].

漸近的クーロン相互作用に煩わされない過程 でも,中性原子から1価イオンへの電子移行(電 荷移行)過程A⁺+B→A+B⁺のような粒子交 換があるいわゆる組替え衝突のボルン級数はい かに高エネルギーでも発散するとの今や古典と も言える「証明」がありますが,微妙な点もあり ます.組替え衝突の摂動論は大変複雑です.

上の電荷移行過程で A^+ , B^+ を構造のない粒 子として扱い,原子A,Bのハミルトニアンと 固有関数を H_A , $\phi_A(\mathbf{r}_A)$, H_B , $\phi_B(\mathbf{r}_B)$,イオン-原子間相互作用と相対運動エネルギー演算子を V_{A^+-B} , T_{A^+-B} , $V_{A^-B^+}$, $T_{A^-B^+}$ とします.電子 移行前後で衝突粒子対,相互作用が変わるので, 全系のハミルトニアン*H*を無摂動部と摂動に

 $H = T_{A^+-B} + H_B + V_{A^+-B} = T_{A^-B^+} + H_A + V_{A^-B^+}$

と,移行前後で異なる別け方が必要そうです.移 行前に適切な別け方では移行後には不適切です. 移行後に合う別け方では移行前に向きません. さらに, A^+ , B^+ , e^- の三つがバラバラという無 摂動状態もあり得ます.別け方に応じて形式理 論的には3種類のボルン級数が作れます.

1 次ボルン近似なら,式(13)のような積分を 移行前型: $(\phi_A(\mathbf{r}_A)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}'}|V_{A^+-B}|\phi_B(\mathbf{r}_B)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}})$ 移行後型: $(\phi_A(\mathbf{r}_A)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}'}|V_{A-B^+}|\phi_B(\mathbf{r}_B)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}})$

のどちらかの摂動により計算します.どちらが 良いと言えませんが,正確な ϕ_A , ϕ_B を使えば両 者が等しいと証明できます.でも,どちらも無 摂動系の矛盾を含み,不自然です.また,問題 を正確に解けばあってもなくても変わりのない $A^+-B^+間相互作用を1次ボルン近似に含めるか$ 取り去るかという二つの流儀があり,結果が全く違います.そしてどちらも特殊例を除き,高エネルギーでも近似が悪く,これに取って替わるいろいろな近似法が提案されています[12].

水素型原子の電子移行 $B(nlm) \rightarrow A(n'l'm')$ の 1次ボルン断面積は高エネルギーでの主要項が $E^{-6-l-l'}$ に比例します.式(19)の励起過程なら, 全散乱角に亘り積分すると主要項は光学的禁制 遷移なら $\propto E^{-1}$,許容遷移なら $\propto E^{-1} \ln E$ なの で[6],電荷移行過程の急速な減少は特殊です. さらに,上で述べた3種のボルン級数のいずれも, 2次ボルン断面積はどんなl,l'でも $\propto E^{-11/2}$ という項を含みます.なんと,高エネルギーになると2次項が1次項に打ち勝ってしまうのです.

その機構は古典的に解釈されます.古典散乱で エネルギー保存則と運動量保存則を満たしなが ら電子が一方のイオンから他のイオンに乗り移 るには,最低2回の2体弾性散乱を経る必要があ るというトーマス(Thomas)の議論です.原子B の電子がまず質量Mの入射イオンA⁺に60°弾 き飛ばされ,A⁺は実験室系で $\theta = \sqrt{2}m_e/3M$ の 反跳を受けます.電子は続いてB⁺に-60°散乱 され,入射A⁺と同じ速度ベクトルで併走してそ れに捕まります.クーロン散乱2回のエネルギー 依存性がそれぞれ $\propto E^{-2}$,2回の~60°散乱によ りA⁺に束縛されるための位相空間体積による 因子が $\propto E^{-3/2}$ で,全体で $E^{-11/2}$ の依存性が出 ます.高いn,l状態ならトーマスの古典論が量 子論的にも正しいことが後に示されました.

3種類のボルン級数のいずれも,電子が A^+ , B⁺に一度ずつ散乱される項が2次ボルン項に含 まれます.実際,Aの角分布の $\theta = \sqrt{2}m_e/3M$ に 古典2重散乱機構によると解釈されるいわゆる トーマスピークが MeV 領域の電荷移行過程で 理論的にも実験的にも確認されています[12].

- [1] 江沢洋, 量子力学 II (裳華房, 2002) §12.
- [2] 砂川重信,散乱の量子論(岩波書店,1977).

[3] 高柳和夫,電子・原子・分子の衝突(培風館, 1972,改訂版 1996).

- [4] 島村 勲, しょうとつ, 第7巻第3号 (2010).
- [5] 島村 勲, しょうとつ, 第8巻第2号 (2011).
- [6] M. Inokuti, Rev. Mod. Phys. 43, 297 (1971).

[7] E. N. Lassettre, A. Skerbele, and M. A. Dillon, J. Chem. Phys. 50, 1829 (1969).

[8] A. Skerbele and E. N. Lassettre, J. Chem. Phys. 58, 2887 (1973).

[9] K. Takayanagi, Electron-Molecule Collisions, eds. I. Shimamura and K. Takayanagi (Plenum, N.Y., 1984), Chap. 1.

[10] E. P. Wigner, Phys. Rev. **73**, 1002 (1948).

[11] J.N. Bardsley and R.K. Nesbet, Phys. Rev. A 8, 203 (1973).

[12] D. P. Dewangan and J. Eichler, Phys. Rep. 247, 59 (1994).

「原子衝突のキーワード」に寄せて - 発案者による趣旨説明のようなもの -

田沼 肇 tanuma-hajime@tmu.ac.jp 首都大学東京 理工学部 物理学専攻 平成 23 年 11 月 4 日原稿受付

学会や研究会では専門が近い人間が集まるほ ど議論が盛り上がる.そこには共通認識として 基礎的な知識が必ず存在する.その知識のレベ ルが高いほど,専門性が高いことになる.一方 で,必ずしも専門が近いとも言えない聴衆の前 で講演をする立場になると,どこまでが説明不 要の常識で,どこからが説明必須の専門用語な のか,といつも迷ってしまう.講演では新しい 知見を披露したいのあって,その分野の専門用 語を非専門家に説明する場所ではないからであ る.そこではいつも葛藤と妥協が生まれている.

私の場合,極低温ヘリウム気体中のイオン移 動度の話をするとき,「換算移動度」,「換算電 場」,「実効温度」,そして「分極極限」について 簡単に説明せざるを得ない.初めての人にとっ ては説明不足に違いないが,何度も聞いている 人にとっては退屈であろう.話す立場としては, より詳しい説明をしたいのだが,新しいことで はないので自重もしている.つまり,高度に専 門的な用語というのは,講演会に参加する全員 にとって不幸な存在と言えるかも知れない.

原子衝突とその周辺にある分野の研究者に 限ってみても,専門家からすると常識であって 欲しいが常識とは呼べない言葉が沢山ある.見 方を変えると,そういう言葉を正しく理解でき れば講演が深く理解できるし,議論もしやすく なり,別の視点からの議論が当該分野の研究を 後押しすることにもつながるかも知れない.基 礎的な知識を共有することで,文化として一段 高い所に上れるかも知れない.

「原子衝突のキーワード」は上記のような不満を解消する助けになることを目的に企画された.上記のような特徴を持つ言葉を"キーワー

ド"として選び,個人的に思い入れのある専門 家によって,非専門家が飽きないように1ペー ジという長さながら,どこにも書いていないほ ど深く解説することを理想としている.

2008年の春,第3代・編集委員長を拝命した ときに「用語集」を企画することを思いついた. 4年近く経ってやっと現実となり感慨深いもの があるが,行く末が心配でもある.完全なボラ ンティアによる企画であるが,趣旨に賛同して 頂ければ,日頃の不満を解決する手段にもなる かも知れない.そこで,二つのお願いをしたい.

1.「常識になって欲しい言葉("キーワード")」 をお持ちの方は,是非とも執筆して下さい.

2.「物理学辞典や Wikipedia ではもの足りない」 と思ったら,編集委員まで申し出て下さい.

私のもう一つの研究テーマである多価イオン の電荷移行衝突の話をするとき、「古典的オー バー・バリアモデル」や「Landau-Zenerの遷移 確率」について説明する気分になれないのは、こ れらの概念の認知度が十分に高く、もはや「常 識」の域に達しているからであろう、「知らない 方が悪い」、「それくらい勉強してから出直して こい」と言えるのが、ここでいう「常識」であ る、しかし、人によって「常識」の中身は違う かも知れない、より多くの"キーワード"達が このシリーズに登場して「常識」となり、それ によって原子衝突分野の研究者の知的レベルを 高めて、この分野を更に発展させていく助けに なることを夢見ている、繰り返し、会員諸氏に 御協力を御願いするものである、

「原子衝突のキーワード」

実効温度 (effective temperature)

金属の中を流れる電子の運動速度は1 cm/s 程 度である.これは電位差による加速と、金属中 の束縛電子との衝突による減速の釣り合いによ ることを、教養レベルの電磁気学で習う筈であ る.同じ原理によって、ある程度密度の高い気 体の中で均一な電場の影響を受けながら運動す る荷電粒子の速度は一定値 v_d を取り、移動速 度 (drift velocity) と呼ばれている.このとき、 荷電粒子の運動エネルギーは一定ではなく、気 体分子の熱運動エネルギーと同様にある分布を 持っている.イオンの場合、その平均値を古典 的で簡単な運動量移行理論に基づいて求めると、 次の結果が得られる [1]:

$$\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle = \frac{1}{2}M\langle V^2\rangle + \frac{1}{2}mv_{\rm d}^2 + \frac{1}{2}Mv_{\rm d}^2$$

ここでmおよびMはイオンおよび気体分子の 質量,vおよびVはイオンと気体分子の運動速 度である.この式から相対運動エネルギーの平 均値 ε を求めると,次式となる:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{1}{2}\mu\left(\langle v^2 \rangle + \langle V^2 \rangle\right) = \frac{1}{2}M\langle V^2 \rangle + \frac{1}{2}Mv_{\rm d}^2$$

ここで μ は換算質量である.右辺の第1項は気 体分子の熱エネルギーであるから

$$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT + \frac{1}{2}Mv_{\rm d}^2$$

と書き直すことができる. ここで k は Boltzmann 定数, T は気体の温度である. この相対 運動エネルギーを温度に変換したものが, 実効 (有効) 温度 T_{eff} である:

$$T_{\rm eff} = \frac{2}{3k}\bar{\varepsilon} \equiv T + \frac{1}{3k}Mv_{\rm d}^2$$

この実効温度の式にはイオンの質量*m*が含まれていないことに注意して欲しい.

より正確な輸送理論に拠れば,この実効温度 には若干の補正が必要であり

$$T_{\rm eff} = T + \frac{1}{3k} M v_{\rm d}^2 \left(1 + \beta'\right)$$

という形で高次の補正項 β' を入れるべきであ る [1]. しかし, この項を実験的に決定すること は困難であり, また補正項は小さくその影響が 十分に小さいことから, 通常は無視されている.

実効温度は 1953 年の G. Wannier の論文 [2] に起源を持つ概念であるが,その妥当性が実験 と計算によって検討され,普及したのは 1970 年 代になってからである.実効温度を用いると, 気体中におけるイオンと分子の平均衝突エネル ギーを容易に評価できるため,異なる気体温度 におけるイオン移動度を比較したり,イオン-分 子反応速度定数の温度依存性などの議論が可能 になるなど,極めて有用な概念と言える.

但し、構造を持った分子の回転・振動の自由 度が関与する非弾性衝突が顕著になると、非弾 性エネルギー損失因子 *ξ* を用いて

$$T_{\rm eff} = \left[1 + \frac{M}{m}\xi\right]^{-1} \left(T + \frac{1}{3k}Mv_{\rm d}^2\right)$$

という形での修正が必要であることが理論的に 示唆されている [3]. 電場と気体密度の比 E/Nが大きな場合には ξ の値は決して無視できるほ ど小さくないことは実験的に明らかになってい る.しかしながら,研究例は非常に少なく,理 論的に ξ を求めることも困難である.近年,化 学種の分析や異性体の分離を目的とした移動速 度の測定が盛んに行われており,それらは多原 子分子イオンやクラスターイオンを対象として いるので,非弾性衝突は無視できない筈である が,分析・分離の目的には殆ど問題とならない ため, ξ に関する理解は未だに進んでいないの が現状である.

なお、多くの異なる分野でも実効温度あるい は有効温度という言葉が別な意味で使われてい ることを付記しておく.

(首都大学東京・田沼肇)

参考文献

- E. A. Mason and E. W. McDaniel, *Transport* Properties of Ions in Gases (John Wiley, New York) 1988.
- [2] G. H. Wannier, Bell Syst. Tech. J. **32** (1953) 170.
- [3] L. A. Viehland *et. al.*, Chem. Phys. **54** (1981) 341.

「原子衝突のキーワード」

エフィモフ状態 (Efimov state)

エフィモフ状態とは、ロシアの理論物理学者で あるヴィタリー・エフィモフ (Vitaly N. Efimov) によって 1970 年に予測された少数体系の量子状 態です [1]. エフィモフの予測は次の通りです: 「2粒子系のs波束縛状態がしきい値近傍に形成 され、s波散乱長aの絶対値が無限に大きくなっ ているとします. このような2体相互作用を持 つ粒子が3つ集まると無限個の束縛状態を作る でしょう.」これらの3体束縛状態はエフィモフ 状態と呼ばれ、同一のスピンなしボース粒子系 では、たとえ類似の2体束縛状態がない場合で も存在できます.

エフィモフ状態は,原子核物理学で提唱され て以来,多くの物理学分野で大きな関心を呼ん できましたが、これらの状態の観測はなかなか 成功しませんでした。原子核物理学では、クー ロン相互作用に阻まれエフィモフ状態の観測は 不可能でした. 原子物理学では、ヘリウム原子 3量体の振動励起状態がエフィモフ状態である と予測されていましたがやはり観測には至りま せんでした [2]. しかし現在, 冷却原子系では磁 場によるフェッシュバッハ共鳴を使って散乱長 を自由に制御することができ、エフィモフ状態 を観測する理想的な状況を作り出すことができ るようになりました. 特に, インスブルックの Grimm のグループによる 2006 年の超冷セシウ ム原子気体の実験では、エフィモフ状態を示す 証拠が確認されています [3].

エフィモフ状態の物理的原因は3体系に現れ る有効ポテンシャルの漸近での振舞にあります. 粒子*i*と粒子*j*の距離を r_{ij} と書き,3体系のサ イズRを $R^2 = r_{12}^2 + r_{23}^2 + r_{31}^2$ と表すことにしま しょう.3体系の有効ポテンシャルは半径*a*の 球の内部では引力的な $1/R^2$ の様に振る舞いま す.したがって,*a*が無限大となる時,引力的 逆数2乗型ポテンシャルで相互作用する2体系 と同様に,無限個の束縛エネルギー準位が現れ



図 1: 散乱長の逆数 (つまり 1/a)の関数としての 3 体系のエネルギースペクトル. 束縛状態と連続状態の間のしきいは線影で表されており、1/a < 0 では 3 体解離のしきいに、1/a > 0 では 2 体・1 体と解離するしきいになります.

るのです.

図1は1/aの関数としての3体系のエネルギー スペクトルを表しています.1/aが負から正とな る方向に変化するとき,ある負のaの値で3体解 離のしきいからエフィモフ状態が現れ, $|a| = \infty$ となる点を通過して1/a > 0の領域に接合し,最 後に2体・1体解離のしきいで連続状態に吸収さ れ消滅します.普遍スケール則により,エフィ モフ状態は散乱長が22.7倍大きく,束縛エネル ギーが1/515倍小さくなるごとに1個増加しま す.よって,図の原点(1/a, E) = (0,0)では相似 の束縛状態が無限個現れることになります.

現在複数のグループでエフィモフ状態の実験 が進められています.特に,短距離力で決定さ れるところのエフィモフ状態の束縛エネルギー が,2体系ファン・デル・ワールス係数を用い て規格化すると,ほぼ原子種に依存しないとい う「普遍性」は興味深い問題であるといえます. (海洋研究開発機構・数納広哉)

参考文献

- V. Efimov, Phys. Lett. B 33 (1970) 563;
 J. Nucl. Phys. 12 (1971) 589.
- [2] R. Brühl *et al.*, Phys. Rev. Lett. **95** (2005) 063002.
- [3] T. Kraemer *et al.*, Nature **440** (2006) 7082.

「原子衝突のキーワード」

ドレスト原子 (dressed atom)

強レーザー場中におかれた原子の電子状態を 記述する方法として、ドレスト原子 (dressed atom) という見方がある. これは文字通り、光の衣を纏っ た原子という意味であるが、このような見方をする 理論背景と、ドレスト原子に立脚した電子状態の 簡単な記述例を紹介する.

電磁場存在下における原子の時間依存シュレ ディンガー方程式を考える (以下,本稿では一貫 して原子単位系を用いる). 簡単のため,周波数 ω の単ーモードのレーザー場を考えることにする と,ハミルトニアンは周期 $T = 2\pi/\omega$ の時間周期性 を持つ.すると,固体物理で登場する,周期結晶 場におけるブロッホの定理と類似した「フロケの定 理」により,波動関数 $\Psi(t)$ は,時間周期性を持 つ関数 $\Phi(t+T) = \Phi(t)$ と,擬固有エネルギー ε による位相因子 $e^{-i\alpha}$ の積の形で表される:

$$\Psi(t) = e^{-i\varepsilon t} \Phi(t) \,. \tag{1}$$

$$\hat{H} = \hat{H}_{atom} + \vec{E}_0 \cos \omega t \cdot \sum_i \vec{r}_i \qquad (2)$$

と表し、原子の電子状態は双極子許容な二準位 系(基底状態をg、励起状態をuとし、それぞれの 固有エネルギーを E_{g} 、 E_{u} とする)で表されるとする と、この固有値方程式は次の形を取る:

$$\begin{pmatrix} E_{g} + \omega(n-2) & \vec{E}_{0} \cdot \vec{T}_{gu} / 2 & 0 & 0 \\ \vec{E}_{0} \cdot \vec{T}_{ug} / 2 & E_{u} + \omega(n-1) & \vec{E}_{0} \cdot \vec{T}_{ug} / 2 & 0 \\ 0 & \vec{E}_{0} \cdot \vec{T}_{gu} / 2 & E_{g} + \omega n & \vec{E}_{0} \cdot \vec{T}_{gu} / 2 \\ 0 & 0 & \vec{E}_{0} \cdot \vec{T}_{ug} / 2 & E_{u} + \omega(n+1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_{n-2} \\ \varphi_{n} \\ \varphi_{n} \\ \varphi_{n+1} \end{pmatrix}$$

$$= \varepsilon \begin{pmatrix} \varphi_{n-2} \\ \varphi_{n-1} \\ \varphi_{n} \\ \varphi_{n+1} \end{pmatrix}.$$
(3)

 $\vec{T}_{gu} = \vec{T}_{ug}$ は遷移モーメント、 $\{\varphi_n\}$ は各フーリ エ成分を表す. 式 (3) 左辺の「フロケ行列」の対



図 1. 近共鳴レーザー場と相互作用する二準位系. (a):ドレスト原子の立場をとらない通常の光学遷移. (b),(c):ドレスト原子の立場で表したエネルギー準 位構造(lg, n>と相互作用する状態のみを表示).(b)お よび(c)はそれぞれ,場との結合が弱い場合,および 強い場合を表す.(b)の状態記号|g, n>, |u, n-1>等は式 (3)の固有状態の主成分を表す.

角要素に着目すると、個々の要素は、原子の固 有エネルギーに対して一光子エネルギーωのn-2. n-1, n, n+1, ... 倍の嵩上げがあることが分かる. こ れは、各電子状態に対して、それぞれ光子がn-2、 n-1, n, n+1, ... 個結合していると解釈することがで き、この電子系と光子系の直積状態を|u,n-1)、 |g,n>などと書く. 式(3)ではフロケ行列の 4×4 成 分のみが表示されているが,本来は同じ構造が 周期的に繰り返される無限次元行列である. 近共 鳴(ω≈E_n-E_n)の場合に,二準位系の準位構 造を模式的に表したものを図1に示す. レーザー 強度が弱い図 1 (b) の場合には、ドレスト原子は フロケ行列の対角要素で近似される準位構造を 持つ. 一方, 強レーザーの場合には, 式(3) の非 対角要素 $\vec{E}_0 \cdot \vec{T}_m$ /2が無視できなくなり、これら の準位が互いに反発し合い有意なレベルシフトを 起こす[図 1(c)]. このような状態をドレスト状態と呼 ぶ. さらにレーザー強度が増すと、原子準位の単 純な線形結合を超えた全く新しい状態 (光誘起 状態)が生成することが理論的に予想されている. (日本大学·佐甲徳栄)

2011 年度 役員・委員会等

会長 伊藤秋男 (京都大学) 幹事 今井 誠 (京都大学) 市村 淳(宇宙航空研究開発機構) 高口博志 (広島大学) 本橋健次(東洋大学) 運営委員 石井邦和 (奈良女子大学) 市村 淳 (宇宙航空研究開発機構) 今井 誠 (京都大学) 加藤太治(核融合科学研究所) 北島昌史(東京工業大学) 高口博志 (広島大学) 河内宣之(東京工業大学) 酒井康弘 (東邦大学) 高橋正彦 (東北大学) 田沼 肇(首都大学東京) 長嶋泰之(東京理科大学) 星野正光 (上智大学) 間嶋拓也 (京都大学) 美齊津文典 (東北大学) 本橋健次(東洋大学) 森下 亨 (電気通信大学) 柳下 明(高エネルギー加速器研究機構) 渡辺信一(電気通信大学) 渡部直樹(北海道大学) 会計監事 中村義春 (東京電機大学) 鵜飼正敏 (東京農工大学) 常置委員会等 編集委員会 委員長: 市村 淳(宇宙航空研究開発機構) 行事委員会 委員長: 高口博志(広島大学) 広報渉外委員会 委員長: 本橋健次(東洋大学) 若手奨励賞選考委員会 委員長: 島村 勲(理化学研究所) 国際会議発表奨励者選考委員会 委員長: 伊藤秋男(京都大学) 担当幹事:今井 誠 (京都大学) 協会事務局

しょうとつ 第8巻 第6号 (通巻 43 号)

Journal of Atomic Collision Research ⓒ原子衝突研究協会 2011 http://www.atomiccollision.jp/ 発行: 2011 年 11 月 15 日 配信: 原子衝突研究協会 事務局 <acr-post@bunken.co.jp>